PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-341539

(43)Date of publication of application: 27.11.2002

(51)Int.Cl.

G03F 7/039 C08F220/10 C08F232/00 C08F234/00 C08K 5/16 C08K 5/34 C08K 5/36 C08L 33/04 C08L 45/00 G03F 7/004 H01L 21/027

(21)Application number : 2001-149620

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

18.05.2001

(72)Inventor: SATO KENICHIRO

KODAMA KUNIHIKO

(30)Priority

Priority number: 2001068849

Priority date: 12.03.2001

Priority country: JP

(54) POSITIVE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive resist composition excellent in resolution and exposure margin, which can be suitably used for microphotofabrication using far—UV rays, particularly ArF excimer laser light.

SOLUTION: The positive resist composition contains (A) a specified resin which has aliphatic cyclic hydrocarbon groups and increases the dissolving rate with respect to an alkali developer by the effect of an acid and (B) a specified compound which produces an acid by irradiation with active rays or radiation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.11.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-341539 (P2002-341539A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
G03F 7/039	. 601	G03F 7/039	601 2H025
C08F 220/10		C08F 220/10	4 J 0 O 2
232/00		232/00	4J100
234/00		234/00	
C08K 5/16		C08K 5/16	
	審査請求	未請求 請求項の数5 OL	(全 105 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2001-149620(P2001-149620)	(71)出願人 000005201 富士写真フィ	ルム株式会社
(22)出願日	平成13年5月18日(2001.5.18)		柄市中沼210番地
(31)優先権主張番号	特顧2001-68849 (P2001-68849)	9) 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写	
(32)優先日	平成13年3月12日(2001.3.12)	真フイルム株	式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 児玉 邦彦	
		静岡県榛原郡	吉田町川尻4000番地 富士写
		真フイルム株	式会社内
		(74)代理人 100105647	
		弁理士 小栗	昌平 (外4名)
		1 '	

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

(57)【要約】

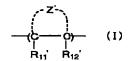
【課題】遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用したミクロフォトファブリケーションに於いて好適に使用することができる、解像力、露光マージンの優れたポジ型レジスト組成物を提供すること。

【解決手段】(A) 脂肪族環状炭化水素基を有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する特定の樹脂、及び(B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する特定の化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 脂肪族環状炭化水素基を有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、及び(B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物において、(A) の樹脂が、下記一般式(I) で表される繰返し構造単位、及び一般式(II) で表される繰返し構造単位、及び一般式(II) で表される繰返し構造単位を有する樹脂であり、(B) の化合物が、下記一般式(Ia) 又は一般式(IIb) で表される化合物であることを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化1】



式(I)中:R11',R12'は、各々独立に、水素原子、シアノ基、ハロゲン原子、又はアルキル基を表す。 Z'は、結合した2つの炭素原子(C-C)を含み、置換基を有していてもよい脂環式構造を形成するための原子団を表す。

【化2】

一般式 (II) 中: Z2は、-O-又は-N(R41) - を表す。ここでR41は、水素原子、水酸基、アルキル基、ハロアルキル基、又は-OSO2-R42を表す。R42は、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基 30又は樟脳残基を表す。

【化3】

一般式(III)中:Re1は、水素原子、低級アルキル基、ハロゲン原子又は一CNを表す。X5は、一〇一、一S一、一NR93一、又は一NR93S〇2一を表す。Re3は、水素原子、鎖状又は環状アルキル基を表す。Bは、単結合または連結基を表す。Re2は、水素原子、鎖状又は環状アルキル基、アルコキシ基、水酸基、カルボキシ基、シアノ基、一COOR94、又は下記一般式(IV)~(X)のいずれかで表される基を表す。Re4は、水素原子、または鎖状又は環状アルキル基を表す。

 $-N^{+}(R_{95}) (R_{96}) (R_{97}) \cdot X^{-} (VIII)$ $-R_{98}-A_{50}-R_{99} (IX)$ $-SO_3R_{100} (X)$

式 (IV) において、Rai、Rbi、Rci、Rdi、及 びReiは、各々独立に、水素原子又は炭素数1~4の アルキル基を表す。m、nは各々独立に0~3の整数を 表し、m+nは、2以上6以下である。式(V-1)~(V-4)において、R16~R5bは、各々独立に、水素 原子、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基 を表す。R1b~R5bの内の2つは、結合して環を形成し てもよい。式 (VII) において、Ria~Radは、各々独 立に、水素原子又はアルキル基を表す。Raoは、水素原 子、鎖状または環状アルキル基、アリール基又はアラル キル基を表す。mは、1~10の整数を表す。式(VII 1) 中、R₉₅~R₉₇は、各々独立に、水素原子、鎖状ま たは環状アルキル基、アルケニル基、アリール基、又は アラルキル基を表す。但し、Ros~Rorは互いに結合し て非芳香環、芳香環を形成しても良い。X-は、R-S O₃-を表す。Rは脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素 基を表す。式(IX)中、Rssは、単結合、アルキレン 基、アリーレン基、又はこれらを組み合わせた2価の基

50 を表す。Asoは、下記に示す官能基のいずれかを表す。

R99は、水素原子またはアルキル基を表す。式 (X)中、R100は、鎖状又は環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。

【化6】

$$R_1$$
 $R_2 - S^+ \quad X^- \qquad (Ia)$
 R_3

(上記式中、 $R_1 \sim R_5$ は、各々独立に、置換基を有していてもよい脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基を表す。但し、 $R_1 \sim R_3$ の内の2個は、互いに結合して環を形成してもよく、また、 R_4 と R_5 とは、互いに結合して環を形成してもよい。 X^- は、下記のアニオンのいずれかを表す。)

【化7】

x-:

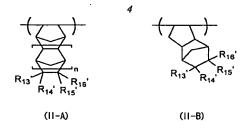
(上記式中、 $R_6 \sim R_{10}$ は、各々独立に、置換基を有していてもよい脂肪族炭化水素基を表す。但し、 $R_6 \wr R_7$ とは、互いに結合して環を形成してもよく、また、 $R_8 \sim R_{10}$ の内の 2 個は、互いに結合して環を形成してもよ 40 い。)

【請求項2】 前記一般式(I)におけるZが、結合した2つの炭素原子(C-C)を含み、置換基を有していてもよい有橋式脂環式構造を形成するための原子団を表すことを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項3】前記一般式(I)が、下記一般式(II-A)又は一般式(II-B)であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【化8】

特開2002-341539



式 (II-A) 、 (II-B) 中: R13'~R16'は、各々独 立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、-COO 10 H、-COOR5、酸の作用により分解する基、-C (=O) -X-A'-R₁₇'、又は置換基を有していても よいアルキル基あるいは環状炭化水素基を表す。ここ で、Rsは、置換基を有していてもよい、アルキル基、 環状炭化水素基又は下記の一Y基を表す。Xは、酸素原 子、硫黄原子、-NH-、-NHSO2-又は-NHS O2 NH-を表す。A'は単結合又は2価の連結基を表 す。また、R13'~R16'のうち少なくとも2つが結合し て環を形成してもよい。nは0又は1を表す。R17' は、-COOH、-COORs、-CN、水酸基、置換 20 基を有していてもよいアルコキシ基、-CO-NH-R 6、-CO-NH-SO2-R6又は下記の-Y基を表 す。R6は、置換基を有していてもよい、アルキル基又 は環状炭化水素基を表す。-Y基;

【化9】

(3)

(-Y基中、R21'~R30'は、各々独立に、水素原子又 30 は置換基を有していてもよいアルキル基を表す。 a, b は1又は2を表す。)

【請求項4】更に、フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項5】更に有機塩基性化合物を含有することを特 像とする請求項1~4のいずれかに記載のポジ型レジス ト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LSIや高容量マイクロチップの製造等の超マイクロリソグラフィブロセスやその他のフォトファブリケーションプロセスに使用するポジ型レジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の製造に於いてはハーフミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。その必要性を満たすためにフォトリソグラフィーに用いられる露光装置の使用波長は益々短波化し、今では、遠紫外線の中でも短波

長のエキシマレーザー光(XeCl、KrF、ArFな

ど)を用いることが検討されるまでになってきている。 この波長領域におけるリソグラフィーのパターン形成に 用いられるものとして、化学増幅系レジストがある。

【0003】一般に化学増幅系レジストは、通称2成分 系、2.5成分系、3成分系の3種類に大別することが できる。2成分系は、光分解により酸を発生する化合物 (以後、光酸発生剤という) とバインダー樹脂とを組み 合わせている。該バインダー樹脂は、酸の作用により分 解して、樹脂のアルカリ現像液中での溶解性を増加させ る基(酸分解性基ともいう)を分子内に有する樹脂であ る。2. 5成分系はこうした2成分系に更に酸分解性基 を有する低分子化合物を含有する。3成分系は光酸発生 剤とアルカリ可溶性樹脂と上記低分子化合物を含有する ものである。

【0004】上記化学増幅系レジストは紫外線や遠紫外 線照射用のフォトレジストに適しているが、その中でさ らに使用上の要求特性に対応する必要がある。ArF光 源用のフォトレジスト組成物としては、ドライエッチン グ耐性付与の目的で脂環式炭化水素部位が導入された樹 脂が提案されているが、脂環式炭化水素部位導入の弊害 として系が極めて疎水的になるがために、従来レジスト 現像液として幅広く用いられてきたテトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド(以下TMAH)水溶液での現像が 困難となったり、現像中に基板からレジストが剥がれて しまうなどの現象が見られる。このようなレジストの疎 水化に対応して、現像液にイソプロピルアルコールなど の有機溶媒を混ぜるなどの対応が検討され、一応の成果 が見られるものの、レジスト膜の膨潤の懸念やプロセス が煩雑になるなど必ずしも問題が解決されたとは言えな い。レジストの改良というアプローチでは親水基の導入 により疎水的な種々の脂環式炭化水素部位を補うという 施策も数多くなされている。

【0005】特開平10-10739号公報には、ノル ボルネン環等の脂環式構造を主鎖に有するモノマー、無 水マレイン酸、カルボキシル基を有するモノマーを重合 して得られる重合体を含むエネルギー感受性レジスト材 料を開示している。特開平10-11156.9号公報に は、主鎖に脂環式骨格を有する樹脂と感放射線性酸発生 剤とを含有する感放射線性樹脂組成物が開示されてい

【0006】特開平10-130340号公報には、ノ ルポルネン構造を主鎖に有する特定の繰り返し構造単位 を有するターポリマーを含有する化学増幅型のレジスト が開示されている。特開平11-305444号公報に は、アダマンタン構造を側鎖に有する繰り返し構造単位 と、無水マレイン酸を繰り返し構造単位として含有する 樹脂が開示されている。EP1048983A1は、保 存安定性、透明性、ドライエッチング性、感度、解像 度、パターン形状等の改良を目的として、特定の酸分解

性基を有するノルボルネンからなる繰り返し単位、無水 物からなる繰り返し単位、及び脂環式基を有する繰り返 し単位を有する樹脂を含有する組成物を開示している。 特表平11-501909号は、開始剤、硬化剤、また は触媒として使用する塩の有機溶剤に対する溶解性、触 媒活性を向上する点から、アニオンとして強酸であるイ ミド又はメチド酸を有する化合物を提案している。ま た、Research Disclosure 437031では、光分解で イミド又はメチド酸を発生する化合物のレジスト組成物 への応用の可能性を提案している。

【0007】しかしながら、従来のポジ型レジスト組成 物は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用 したミクロフォトファブリケーションに於いて、解像 力、露光マージンの評価で充分な成果が得られていなか った。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、遠紫外光、特にArFエキシマレーザー光を使用し たミクロフォトファブリケーションに於いて好適に使用 することができる、解像力、露光マージンの優れたポジ 型レジスト組成物を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、ポジ型化 学増幅系レジスト組成物の構成材料を鋭意検討した結 果、特定の酸分解性樹脂及び特定の光酸発生剤を用いる ことにより、本発明の目的が達成されることを見出し本 発明に至った。即ち、上記目的は下記構成によって達成 される。

[0010](1)(A) 脂肪族環状炭化水素基を有 30 し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が 増加する樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射に より酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成 物において、(A)の樹脂が、下記一般式(I)で表さ れる繰返し構造単位、一般式(II)で表される繰返し 構造単位、及び一般式(III)で表される繰返し構造 単位を有する樹脂であり、(B)の化合物が、下記一般 式(Ia)又は一般式(IIb)で表される化合物であ ることを特徴とするポジ型レジスト組成物。

[0011]

【化10】

【0012】式 (I) 中: R11', R12'は、各々独立 に、水素原子、シアノ基、ハロゲン原子、又はアルキル 基を表す。 Z'は、結合した 2 つの炭素原子 (C-C) を含み、置換基を有していてもよい脂環式構造を形成す 50 るための原子団を表す。

40

【0014】一般式(II)中: Z2は、-O-又は-N(R41)ーを表す。ここでR41は、水素原子、水酸基、アルキル基、ハロアルキル基、又は-OSO2-R42を表す。R42は、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基又は樟脳残基を表す。

[0015]

【化12】

【0016】一般式(III)中:R91は、水素原子、低級アルキル基、ハロゲン原子又は一CNを表す。X5は、一〇一、一S一、一NR93一、又は一NR93S〇2一を表す。R93は、水素原子、鎖状又は環状アルキル基を表す。Bは、単結合または連結基を表す。R92は、水素原子、鎖状又は環状アルキル基、アルコキシ基、水酸基、カルボキシ基、シアノ基、一COOR94、又は下記一般式(IV)~(X)のいずれかで表される基を表す。R94は、水素原子、または鎖状又は環状アルキル基を表す。

【0017】 【化13】

[0018]

30
$$-N^{+}(R_{95})$$
 (R_{96}) $(R_{97}) \cdot X^{-}$ $(VIII)$
 $-R_{98}-A_{50}-R_{99}$ (IX)
 $-SO_3R_{100}$ (X)

(V-3)

【0019】式 (IV) において、Rai、Rbi、R c1、Rd1、及びRe1は、各々独立に、水素原子又は 炭素数1~4のアルキル基を表す。m、nは各々独立に 0~3の整数を表し、m+nは、2以上6以下である。 式 (V-1)~(V-4) において、R1b~R5bは、各 々独立に、水素原子、アルキル基、シクロアルキル基又 はアルケニル基を表す。R1b~R5bの内の2つは、結合 40 して環を形成してもよい。式 (VII) において、R1a~ Reaは、各々独立に、水素原子又はアルキル基を表す。 Raoは、水素原子、鎖状または環状アルキル基、アリー ル基又はアラルキル基を表す。mは、1~10の整数を 表す。式(VIII)中、R®5~R®7は、各々独立に、水 素原子、鎖状または環状アルキル基、アルケニル基、ア リール基、又はアラルキル基を表す。但し、R95~R97 は互いに結合して非芳香環、芳香環を形成しても良い。 X⁻は、R-SO₃⁻を表す。Rは脂肪族炭化水素基又は 芳香族炭化水素基を表す。式(IX)中、Rssは、単結 50 合、アルキレン基、アリーレン基、又はこれらを組み合

わせた2価の基を表す。A50は、下記に示す官能基のいずれかを表す。

.

【0021】Rooは、水素原子またはアルキル基を表す。式(X)中、Rooは、鎖状又は環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。

[0022] 【化15】 R₂-s⁺ X (Ia) R₃

【0023】(上記式中、 $R_1 \sim R_5$ は、各々独立に、置換基を有していてもよい脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基を表す。但し、 $R_1 \sim R_3$ の内の2個は、互いに結合して環を形成してもよく、また、 $R_4 \geq R_5 \geq$ は、互いに結合して環を形成してもよい。 X^- は、下記のアニオンのいずれかを表す。)

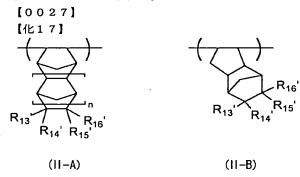
(IIb)

【0025】(上記式中、R6~R10は、各々独立に、 置換基を有していてもよい脂肪族炭化水素基を表す。但 し、R6とR7とは、互いに結合して環を形成してもよ く、また、R8~R10の内の2個は、互いに結合して環 を形成してもよい。)

【0026】(2) 前記一般式(I)におけるZ'が、結合した2つの炭素原子(C-C)を含み、置換基を有していてもよい有橋式脂環式構造を形成するための原子団を表すことを特徴とする(1)に記載のポジ型レ

ジスト組成物。

(3) 前記一般式(I)が、下記一般式(II-A)又は一般式(II-B)であることを特徴とする(1)に記載のポジ型レジスト組成物。



【0028】式 (II-A) 、 (II-B) 中: R13'~R 16 は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、-COOH、-COORs、酸の作用により分解す る基、-C (=O) -X-A'-R17'、又は置換基を有 20 していてもよいアルキル基あるいは環状炭化水素基を表 す。ここで、Rsは、置換基を有していてもよい、アル キル基、環状炭化水素基又は下記の-Y基を表す。X は、酸素原子、硫黄原子、-NH-、-NHSO₂-又 は-NHSO2NH-を表す。A'は単結合又は2価の連 結基を表す。また、R13'~R16'のうち少なくとも2つ が結合して環を形成してもよい。 nは0又は1を表す。 R₁₇'は、-COOH、-COORs、-CN、水酸基、 置換基を有していてもよいアルコキシ基、-CO-NH -R₆、-CO-NH-SO₂-R₆又は下記の-Y基を 30 表す。R6は、置換基を有していてもよい、アルキル基 又は環状炭化水素基を表す。-Y基;

[0029] [化18] R₂₅ R₂₁ R₂₃ R₂₄ R₂₉ R₂₉ O

【0030】(-Y基中、R21'~R30'は、各々独立 40 に、水素原子又は置換基を有していてもよいアルキル基 を表す。a, bは1又は2を表す。)

【0031】(4) 更に、フッ素系及び/又はシリコン 系界面活性剤を含有することを特徴とする(1) ~

- (3) のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。
- (5) 更に有機塩基性化合物を含有することを特徴とする(1)~(4)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

00321

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する成分につ 50 いて詳細に説明する。

11

. . .

[1] (A) 酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂 (「酸分解性樹脂」ともいう)。

【0033】本発明の(A) 酸分解性樹脂としては、脂肪族環状炭化水素基を有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する、上記一般式(I)で表される繰返し構造単位、上記一般式(II)で表される繰返し構造単位、及び上記一般式(III)で表される繰返し構造単位を有する樹脂が使用される。

【0034】上記一般式(I)において、R11'、R12'は、各々独立に、水素原子、シアノ基、ハロゲン原子、又は置換基を有していてもよいアルキル基を表す。 Z'は、結合した2つの炭素原子(C-C)を含み、置換基を有していてもよい脂環式構造を形成するための原子団を表す。

【0035】上記R11、R12、におけるハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。上記R11、R12、R21、~R30、におけるアルキル基としては、炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、イソプチル基、

 $sec-プチル基、 t-プチル基である。また、 <math>R_{11}$ '、 R_{12} '、 R_{21} ' $\sim R_{30}$ ' におけるアルキル基は、置換基を有していてもよい。

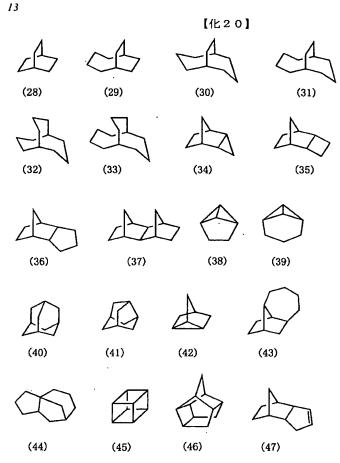
【0036】上記のアルキル基における更なる置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシ基、アシル基、シアノ基、アシルオキシ基等を挙げることができる。ハロゲン原子としては塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができ、アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができ、アシル基としてはホルミル基、アセチル基等を挙げることができ、アシルオキシ基としてはアセトキシ基等を挙げることができる。

【0037】上記2'の脂環式構造を形成するための原子団は、置換基を有していてもよい脂環式炭化水素の繰り返し単位を樹脂に形成する原子団であり、中でも有橋式の脂環式炭化水素の繰り返し単位を形成する有橋式脂環式構造を形成するための原子団が好ましい。形成される脂環式炭化水素の骨格としては、下記構造で示すもの等が挙げられる。

[0038]

【化19】 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (13) (10)(11)(12)(17)(14)(15)(16)(18)(19)(20)(21) (22)(24)(25)(26)(23)(27)

[0039]



【0040】好ましい有橋式の脂環式炭化水素の骨格としては、上記構造のうち、(5)、(6)、(7)、(9)、(10)、(13)、(14)、(15)、(23)、(28)、(36)、(37)、(42)、(47)が挙げられる。

【0041】上記脂環式炭化水素の骨格には置換基を有 していてもよい。そのような置換基としては、上記一般 式 (II-A) あるいは (II-B) 中のR13'~R16'を挙 げることができる。上記有橋式の脂環式炭化水素を有す る繰り返し単位の中でも、上記一般式(II-A)あるい は(II-B)で表される繰り返し単位が更に好ましい。 【0042】上記一般式 (II-A) あるいは (II-B) において、R13'~R16'は、各々独立に、水素原子、ハ ロゲン原子、シアノ基、-COOH、-COOR₅、酸 の作用により分解する基、-C (=O) -X-A'-R17'、又は置換基を有していてもよいアルキル基あるい は環状炭化水素基を表す。Rsは、置換基を有していて もよい、アルキル基、環状炭化水素基又は前記の-Y基 を表す。Xは、酸素原子、硫黄原子、-NH-、-NH SO2-又は-NHSO2NH-を表す。A'は、単結合 または2価の連結基を表す。また、R13'~R16'のうち 少なくとも2つが結合して環を形成してもよい。 n は0 又は1を表す。R₁₇'は、-COOH、-COORs 、

-CN、水酸基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、-CO-NH-R6、-CO-NH-SO2-R6

30 又は下記の-Y基を表す。R6は、置換基を有していてもよい、アルキル基又は環状炭化水素基を表す。前記-Y基において、R21'~R30'は、各々独立に、水素原子又は置換基を有していてもよいアルキル基を表し、a、bは1又は2を表す。

【0043】上記 R_{13} 、 R_{16} 、におけるハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0044】上記R5、R6、R13、~R16、におけるアルキル基としては、炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ロープチル基、イソプチル基、secープチル基、tープチル基である。

【0045】上記Rs、Re、R13'~R16'における環状 炭化水素基としては、例えば環状アルキル基、有橋式炭 化水素であり、シクロプロピル基、シクロペンチル基、 シクロヘキシル基、アダマンチル基、2-メチル-2-アダマンチル基、ノルボルニル基、ボロニル基、イソボ 50 ロニル基、トリシクロデカニル基、ジシクロペンテニル

40

15

基、ノボルナンエポキシ基、メンチル基、イソメンチル 基、ネオメンチル基、テトラシクロドデカニル基等を挙 げることができる。上記R13 ~R16 のうち少なくとも 2つが結合して形成する環としては、シクロペンテン、 シクロヘキセン、シクロヘプタン、シクロオクタン等の 炭素数5~12の環が挙げられる。

【0046】上記R17 におけるアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。

【0047】上記アルキル基、環状炭化水素基、アルコキシ基における更なる置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキシ基、アシル基、シアノ基、アシルオキシ基、アルキル基、環状炭化水素基等を挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものが挙げることができ、アシル基としてはホルミル基、アセチル基等を挙げることができ、アシルオキシ基としてはアセトキシ基等を挙げることができる。また、アルキル基、環状炭化水素基は、上記で挙げたものが挙げられる。

【0048】上記A'の2価の連結基としては、アルキレン基、置換アルキレン基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基、ウレア基よりなる群から選択される単独あるいは2つ以上の基の組み合わせが挙げられ

る。上記A' におけるアルキレン基、置換アルキレン基 としては、下記式で表される基を挙げることができる。 - [C (R。)(R。)], -

16

式中、R。、R。は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。rは1~10の整数を表す。

【0049】上記一般式(II-A)あるいは一般式(II-B)におけるR13'~R16'の各種置換基は、上記一般式(I)における脂環式構造を形成するための原子団ないし有橋式脂環式構造を形成するための原子団Zの置換基ともなるものである。

【0050】上記一般式(II-A)あるいは一般式(II-B)で表される繰り返し単位の具体例として次の[II-1]~[II-175]が挙げられるが、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。

[0051]

【化21】

[0052]

【化22】

[0053]

30 【化23】

H₃C-O₂S-HN-OC-H₂CH₂C C(CH₃)₃ H₃CO₂S CH₂OCH₂CH₃

[0054]

【化24】

(13) [11-32] [11-34] CH2CH2OCH2CH3 CH₂COOH CH(CH³)COOH

【化25】

[0055]

[0056]

【化26】

[0057]

【化27】

[0058]

.:

【化28】

CH2OCH2CH3

特開2002-341539

[0059]

【化29】

[0060]

【化30】

[0061]

【化31】

[11-93] [11-94] CH2CH2OCH2CH3

[0062]

【化32】

[0063]

[0064]

【化34】

[0065]

【化35】

[0066]

-24-

[0068]

[11-169]

[11-171]

[11-172]

[0069]

【化39】 [11-173]

【0070】上記一般式 (II) に於いて、Z2は、-O-又は-N(R41)-を表す。ここでR41は、水素原 子、水酸基、アルキル基、ハロアルキル基、又は一OS O2-R42を表す。R42は、アルキル基、ハロアルキル 基、シクロアルキル基又は樟脳残基を表す。

【0071】上記R41及びR42におけるアルキル基とし ては、炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐状アルキ ル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6個の直鎖 状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメ チル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、イソプチル基、secープチル基、tープチ ル基である。上記R41及びR42 におけるハロアルキル 基としてはトリフルオロメチル基、ナノフルオロプチル 基、ペンタデカフルオロオクチル基、トリクロロメチル 基等を挙げることができる。上記R42 におけるシクロ アルキル基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシ 50 ル基、シクロオクチル基等を挙げることができる。

【0072】R41及びR42としてのアルキル基及びハロ 20 アルキル基、R42としてのシクロアルキル基又は樟脳残 基は置換基を有していてもよい。このような置換基とし ては、例えば、水酸基、カルボキシル基、シアノ基、ハ ロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素原子、フッソ素原 子、沃素原子)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~ 4、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブ トキシ基等)、アシル基(好ましくは炭素数2~5、例 えば、ホルミル基、アセチル基等)、アシルオキシ基 (好ましくは炭素数2~5、例えばアセトキシ基)、ア リール基(好ましくは炭素数6~14、例えばフェニル 30 基) 等を挙げることができる。

【0073】上記一般式(II)で表される繰り返し単 位の具体例として次の [I'-1] ~ [I'-7] が挙げ られるが、本発明はこれらの具体例に限定されるもので はない。

[0074] 【化40】

$$\begin{array}{c}
-(CH-CH)-\\
0 = C \\
N \\
CH_3
\end{array}$$
[I'-4]

[0075] 【化41】

$$\begin{array}{c}
-(CH-CH) \\
O = C \\
N \\
O - SO_2 - CF_3
\end{array}$$
[1'-6]

$$(CH - CH)$$
 $0 = C$
 $0 - SO_2$
 0
 0

【0076】次に、一般式(III)で表される繰り返し 単位について説明する。式(III)において、Raiは、 水素原子、低級アルキル基、ハロゲン原子、又はシアノ 基を表す。Re1の低級アルキル基としては、炭素数1~ 5のものが好ましく、メチル基、エチル基、プロビル 基、プチル基、ペンチル基などが挙げられる。この低級 アルキル基は、更に置換基を有していてもよい。このよ うな置換基としては、例えば、水酸基、カルポキシル 基、シアノ基、ハロゲン原子(例えば、塩素原子、臭素

しくは炭素数1~4、例えばメトキシ基、エトキシ基、 プロポキシ基、ブトキシ基等)、アシル基(好ましくは 炭素数2~5、例えば、ホルミル基、アセチル基等)、 アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~5、例えばアセ トキシ基)、アリール基(好ましくは炭素数6~14、 例えばフェニル基) 等を挙げることができる。

[0077] X_5 は、-O-、-S-、 $-NR_{93}-$ 、又 は-NR93SO2-を表す。R93は、水素原子、鎖状又 は環状アルキル基を表す。Rssとしての鎖状アルキル基 10 としては、低級アルキル基であり、炭素数1~5のもの が好ましく、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル 基、ペンチル基などが挙げられる。環状アルキル基とし ては、例えば炭素数3~12のものが挙げられる。これ らは更に置換基を有していてもよく、置換基としては、 例えば、水酸基、カルボキシル基、シアノ基、ハロゲン 原子(例えば、塩素原子、臭素原子、フッソ素原子、沃 素原子)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4、例 えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ 基等)、アシル基(好ましくは炭素数2~5、例えば、 20 ホルミル基、アセチル基等)、アシルオキシ基(好まし くは炭素数2~5、例えばアセトキシ基)、アリール基 (好ましくは炭素数6~14、例えばフェニル基)等を 挙げることができる。

【0078】Bは、単結合または連結基を表す。Bの連 結基としては、例えばアルキレン基、シクロアルキレン 基、エーテル基、チオエーテル基、カルポニル基、エス テル基よりなる群から選択される単独或いは2つ以上の 基の組み合わせを挙げることができる。Bのシクロアル キレン基としては、好ましくは炭素数3~10のものが 30 挙げられ、例えばシクロペンチレン基、シクロヘキシレ ン基、シクロオクチレン基を挙げることができる。Bの アルキレン基としては、下記式で表される基を挙げるこ とができる。

- (C (Rx)(Ry))z -

Rx及びRyは、各々独立に、水素原子、水酸基、ハロゲ ン原子、置換基を有していても良い、鎖状又は環状アル キル基、アルコキシ基、アルケニル基、アリール基、又 はアラルキル基を表す。但し、Rx及びRyは互いに結合 して環状アルキル環を形成しても良い。Rx又はRyの鎖 40 状アルキル基としては、直鎖状あるいは分岐状のアルキ ル基が挙げられ、置換基を有していてもよい。直鎖状、 分岐状のアルキル基としては、炭素数1~12個の直鎖 状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましく は炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基 であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル 基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、s e c - プチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシ ル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基で ある。環状のアルキル基としては、炭素数3~30個の 原子、フッソ素原子、沃素原子)、アルコキシ基(好ま 50 ものが挙げられ、酸素原子、窒素原子等のヘテロ原子を

含んでいてもよい。具体的には、シクロプロピル基、シ クロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、 ノルボルニル基、ボロニル基、トリシクロデカニル基、 ジシクロペンテニル基、ノボルナンエポキシ基、メンチ ル基、イソメンチル基、ネオメンチル基、テトラシクロ ドデカニル基、ステロイド残基、テトラヒドロピラニル 基、モルホリノ基等を挙げることができる。アルコキシ 基としては、一般的には炭素数1~12個、好ましくは 炭素数1~10個、更に好ましくは1~4個のものが挙 げられ、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、プトキシ基等を挙げることができる。アルケニル基 としては、炭素数2~6個のアルケニル基が挙げられ、 置換基を有していてもよい。具体的にはビニル基、プロ ペニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキ セニル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基、 3-オキソシクロヘキセニル基、3-オキソシクロペン テニル基、3-オキソインデニル基等が挙げられる。こ れらのうち環状のアルケニル基は酸素原子を含んでいて もよい。アリール基としては、炭素数6~10個のもの が挙げられ、置換基を有していてもよい。具体的にはフ エニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。アラ ルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基、ナフチ ルメチル基、ナフチルエチル基、メシチルメチル基を挙 げることができる。上記鎖状又は環状アルキル基、アル コキシ基、アルケニル基、アリール基、又はアラルキル 基が有していてもよい置換基としては、例えば、カルボ キシル基、シアノ基、水酸基、ハロゲン原子(塩素原 子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等)、アルコキシ 基(好ましくは炭素数1~4、例えばメトキシ基、エト キシ基、プロポキシ基、ブトキシ基)、アセチルアミド 基、アルコキシカルボニル基、アシル基(好ましくは炭 素数2~10、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロ ピオニル基)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~ 10、例えばアセトキシ基)、アリール基(好ましくは 炭素数6~14、例えばフェニル基) が挙げられる。R x又はRyとしてアリール基又はアラルキル基について は、置換基として、更にアルキル基(好ましくは炭素数 1~5、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソ プロピル基、プチル基、シクロプロピル基、シクロプチ ル基、シクロペンチル基等)を有していてもよい。この 置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原 子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4、例えばメ トキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基) 等 の置換基を有していてもよい。 Zは1~10の整数であ

【0079】Rozは、水素原子、鎖状又は環状アルキル 基、アルコキシ基、水酸基、カルポキシ基、シアノ基、 -COORs4、又は上記一般式 (IV) ~ (X) のいず れかで表される基を表す。R92及びR94としての鎖状ア ルキル基としては、一般的には炭素数1~30、好まし

り、好ましくは、1~4である。

54

くは6~20のものが挙げられる。例えば、メチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nーブチル 基、イソプチル基、secーブチル基、ペンチル基、ネ オペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、 ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリ デシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデ シル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル 基、エイコシル基等を挙げることができる。R92及びR 94としての環状アルキル基としては、一般的に炭素数3 ~40、好ましくは6~20のものが挙げられる。例え 10 ば、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキ シル基、アダマンチル基、ノルボルニル基、ボロニル 基、トリシクロデカニル基、ジシクロペンテニル基、ノ ポルナンエポキシ基、メンチル基、イソメンチル基、ネ オメンチル基、テトラシクロドデカニル基、ステロイド 残基、テトラヒドロピラニル基、モルホリノ基等を挙げ ることができる。

【0080】R92及びR94としての鎖状アルキル基は置 換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、水 酸基、カルボキシル基、シアノ基、ハロゲン原子(例え 20 ば、塩素原子、臭素原子、フッソ素原子、沃素原子)、 アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4、例えばメトキ シ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等)、ア ルコキシカルボニル基、アシル基 (好ましくは炭素数2 ~5、例えば、ホルミル基、アセチル基等)、アシルオ キシ基(好ましくは炭素数2~5、例えばアセトキシ 基)、アリール基(好ましくは炭素数6~14、例えば フェニル基)、アセチルアミド基等を挙げることができ る。ここでアルコキシカルボニル基におけるアルコキシ 基としては、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキ 30 シ基、プトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げるこ とができる。R92及びR94としての環状アルキル基は、 置換基として、カルボキシル基、シアノ基、ハロゲン原 子(塩素原子、臭素原子、フッソ素原子、沃素原子)、 アルコキシ基 (好ましくは炭素数1~4、例えばメトキ シ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等)、ア ルコキシカルポニル基、アシル基(好ましくは炭素数2 ~5、例えば、ホルミル基、アセチル基等)、アシルオ キシ基(好ましくは炭素数2~5、例えばアセトキシ 40 基)、アリール基(好ましくは炭素数6~14、例えば フェニル基)、アセチルアミド基を有していてもよい。 ここでアルコキシカルポニル基におけるアルコキシ基と しては、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、プトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げること ができる。

【0081】Re2が環状アルキル基である上記一般式 (III) で表される繰り返し単位として、下記の一般 式(IIIa)又は上記一般式(IIIb)で表される 繰り返し単位が好ましい。

[0082]

$$\begin{array}{c|c}
 & \begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 &$$

$$-CH_{2}-C-$$

$$O=C$$

$$R_{63}$$

$$R_{64}$$

$$C$$

$$R_{65}$$

$$R_{66}$$

$$R_{66}$$

$$R_{67}$$

$$R_{68}$$

$$R_{68}$$
(111b)

【0083】一般式(IIIa)及び一般式(III b)中、Roは、水素原子、低級アルキル基、ハロゲン 原子、シアノ基を表す。Ro1及びRo2は、低級アルキル 基を表す。Ro3~Rooは、各々独立に水素原子、低級ア ルキル基、低級アルコキシ基又はハロゲン原子を表す。 Ro3とRo4或いはRosとRooは、一緒になってカルボニ ル基を形成してもよい。Ro3とRo5は、連結してアルキ レン鎖を形成してもよい。k及び1は、2~5の整数で ある。

【0084】上記一般式 (IIIa) 及び (IIIb) で表される繰り返し単位においては、 R_{61} が結合している3級炭素原子の存在により酸分解性を示す。 R_{0} は好ましくは水素原子である。 R_{0} 、 R_{61} \sim R_{68} としての低級アルキル基は、炭素数1 \sim 6 であり、好ましくは炭素

数1~4である。具体例として、例えば、メチル基、エチル基、直鎖又は分岐プロピル基、直鎖又は分岐プチル基を挙げることができる。Res~Resとしての低級アルコキシ基は、炭素数1~6であり、好ましくは炭素数1~4である。具体例として、例えば、メトキシ基、エトキシ基、直鎖又は分岐プロポキシ基、直鎖又は分岐プトキシ基を挙げることができる。Ro、Resとしての低級アルコキシ基は、置換基を有していてもよい。置換基としては、10 例えば、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子、メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基(好ましくは炭素数1~3)等を挙げることができる。

56

【0085】ResとRea、又はResとReeとは、一緒になってカルボニル基を形成してもよい。 kと1は、好ましくは2~4、更に好ましくは2又は3である。 Resと kesとが連結して形成してもよいアルキレン鎖としては、メチレン鎖、エチレン鎖、プロピレン鎖等好ましくは炭素数3以下である。

【0086】R92のアルコキシ基としては、一般的には 20 炭素数1~30、好ましくは3~20、更に好ましくは 4~15のものであり、例えば、メトキシ基、エトキシ 基、プロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることができ る。R92のアルコキシ基は、更に置換基を有していても よく、置換基としては、例えば、R92としての鎖状又は 環状アルキル基への置換基として説明したものと同様で ある。

【0087】以下、Rezがアルキル基、アルコキシ基、水素原子である一般式(III)で表される繰り返し単位、及び一般式(IIIa)及び一般式(IIIb)で表される繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0088]

【化43】

[0089]

【化44】

[0090]

【化45】

[0091]

[0092]

【化47】

[0093]

30 【化48】

【0094】*)括弧内の基の数が異なる単位の混合であり、平均で括弧内の基を1.4個有していることを表す。

【0095】また、以下に、一般式 (III) で表される繰返し単位、一般式 (IIIa) で表される繰返し単

位及び一般式(IIIb)で表される繰返し単位に相当 するモノマーの具体例を示すが、本発明はこれらに限定 されるものではない。

【0096】 【化49】

$$= \bigvee_{0}^{H} O \xrightarrow{CH(CH_3)_2}$$

$$= \begin{array}{c} CH_3 & CH_3 \\ CH_3 &$$

$$= \bigvee_{O} O - \bigcup_{CH_3}^{CH_3} \bigvee$$

[0097]

13

$$H_3C$$

16

$$= \bigvee_{0}^{0} \circ \bigvee_{CH_{3}}$$

[0098]

【化51】

$$\begin{array}{c}
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\$$

$$\begin{array}{c} H \\ O \\ \hline \\ CH_3 \\ CH_3 \\ CH_3 \end{array}$$

[0099]

$$\begin{array}{c}
CH_3 & CH_3 \\
O & 10
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O - C - CH_3
\end{array}$$

$$- \bigcup_{0}^{H} O - C - CH_{3}$$

$$= \underbrace{\begin{array}{c} O \\ CH^3 \end{array}}_{CH^3C} \underbrace{\begin{array}{c} O \\ CH^3 \end{array}}_{H^3C}$$

[0100]

【化53】

$$= \underbrace{\overset{CH_3}{\smile}}_{0} \circ \underbrace{-0}_{0}$$

$$= \begin{matrix} H \\ \downarrow \\ O \end{matrix} \bigcirc 0 \end{matrix} \bigcirc 0$$

[0101]

$$= \bigvee_{0}^{CH_3} O \bigvee_{0}$$

41

$$= 0 0 0 CH_3$$

【0102】さらに、式(III) における R_{92} が下記の一般式(IV) で表される構造である繰り返し構造単位について説明する。

【0103】 【化55】

【0104】Rai, Rbi, Rci, Rdi, Reid各

々独立に、水素原子又は炭素数1~4のアルキル基を表す。m, nは各々独立に0~3の整数を表し、m+nは、2以上6以下である。Rai~Reiの炭素数1~4のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、イソプチル基、secープチル基、tープチル基等を挙げることができる。これらのアルキル基はアルコキシ基(好ましくは炭素数1~4)などの置換基で置換されていてもよい。【0105】以下、一般式(IV)の構造を有する繰り返し構造単位の具体例を示すが、これらに限定されるもの

ではない。 【0106】 *【化56】

[0107]

【化57】

[0108]

【化58】

【0109】上記一般式(IV)の構造を有する繰り返し単位の具体例において、露光マージンがより良好になるという点から(IV-17)~(IV-36)が好ましい。更に一般式(IV)の構造としては、エッジラフネスが良好になるという点からアクリレート構造を有するものが好ましい。

【0110】さらに下記の一般式 $(V-1) \sim (V-4)$ のいずれかで表される基を有する繰り返し単位構造 40 について説明する。

【0111】 【化59】

(

【0112】一般式 $(V-1) \sim (V-4)$ において、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ は、各々独立に水素原子、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。 $R_{1b} \sim R_{5b}$ の内の2つは、結合して環を形成してもよい。

【0113】一般式 (V-1) ~ (V-4) において、 R1b~R5bにおけるアルキル基としては、直鎖状、分岐 50 状のアルキル基が挙げられる。直鎖状、分岐状のアルキ

81

ル基としては、炭素数1~12個の直鎖状あるいは分岐 状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~1 0個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好 ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピ ル基、nープチル基、イソプチル基、secープチル 基、tープチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル 基、オクチル基、ノニル基、デシル基である。R1b~R 56におけるシクロアルキル基としては、シクロプロピル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘブ チル基、シクロオクチル基等の炭素数3~8個のものが 10 好ましい。R1b~R5bにおけるアルケニル基としては、 例えばビニル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニ ル基等の炭素数2~6個のものが好ましい。また、R_{1b} ~Rsbの内の2つが結合して形成する環としては、シク ロプロパン環、シクロブタン環、シクロペンタン環、シ クロヘキサン環、シクロオクタン環等の3~8員環が挙 げられる。

【0114】また、 $R_{1b}\sim R_{5b}$ としてのアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基及び $R_{1b}\sim R_{5b}$ の内の2つが結合して形成する環は、それぞれ置換基を有していてもよい。好ましい置換基としては、水酸基、カルボキシ基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、炭素数 $1\sim 4$ 個のアルコキシ基、炭素数 $2\sim 5$ 個のアルコキシカルボニル基、炭素数 $2\sim 5$ 個のアシル基、炭素数 $2\sim 5$ 個のアシロキシ基等を挙げることができる。なお、一般式(V-1)~(V-4)における $R_{1b}\sim R_{5b}$ は、環状骨格を構成している炭素原子のいずれに連結していてもよい。

【0115】一般式 $(V-1) \sim (V-4)$ で表される 基を有する繰り返し単位として好ましいものとして、下 記一般式 (AI) で表される繰り返し単位が挙げられる。

【0116】 【化60】

$$\begin{array}{ccc}
 & R_{b0} \\
 & C \\$$

【0117】一般式(AI)中、Rboは、水素原子、ハロゲン原子、又は炭素数1~4のアルキル基を表す。 Rboのアルキル基は置換基を有していてもよく、好ましい置換基としては、前記一般式(V-1)~(V-4)におけるRboとしてのアルキル基が有していてもよい好ましい置換基として先に例示したものが挙げられる。 Rboのハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子を挙げることができる。 Rbo は水素原子

が好ましい。B2は、一般式(V-1)~(V-4)のうちのいずれかで示される基を表す。A'は、式(III))におけるBの定義と同様である。A'において、該組み合わせた2価の基としては、例えば下記式のものが挙げられる。

[0118] [江61] --(CH₂CH₂--C-O)_m O

$$\begin{array}{c|c}
 & R_{ab} \\
 & C \\
 & C \\
 & R_{bb} \\
 & R_{$$

30 【0119】上記式において、Rab、Rbbは、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基から選択される。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、炭素数1~4のアルコキシ基を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシーを基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシーを表としては、メトキシーのを挙げることができる。ロロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。ロは1~10の整数、好ましくは1~4の整数を表す。

121~10の整数、好ましくは1~4の整数を表す。

121~10の整数、好ましくは17年である。これを表す。

【0120】以下に、一般式(AI)で表される繰り返 し単位の具体例を挙げるが、本発明の内容がこれらに限 定されるものではない。

【0121】 【化62】

$$-(CH_2-C)$$

$$C - O$$

$$(Ib-5)$$

[0122]

【化63】

[0.123]

【0124】 【化65】

特開2002-341539 90

[0126]

【化67】

$$\begin{array}{c} -(CH_2-CH) - \\ O \\ C-O \\ (CH_2)_2-O \\ C - (CH_2)_2-C \\ O \\ (Ib-40) \end{array}$$

[0127]

【化68】

$$CH_{2}-CH$$
 $CH_{2}-CH$
 $CH_$

$$-(CH_2-CH) O(C-O)$$
 $(CH_2)_2-O$
 $(CH_2)_2-C$
 $O(CH_3)_2-C$
 $O(CH_3)$

$$(CH_2-CH)$$
 $(CH_2)_2-O$
 $(CH_$

【0128】次に、下記の一般式(VI)で表される構造を有する繰り返し構造単位について説明する。

[0129]

【化69】

【0130】 Zを含む有橋式脂環式環は、置換基を有していてもよい。置換基としては、例えば、カルボキシル基、水酸基、ハロゲン原子、アルキル基(好ましくは炭素数1~4)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2~4)、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭素数2~

5)、アシル基(例えば、ホルミル基、ベンゾイル基)、アシロキシ基(例えば、プロピルカルボニルオキシ基、ベンゾイルオキシ基)、アルキルスルホニルスルファモイル基(-CONHSO2CH3等)が挙げられる。尚、置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4)等で置換されていてもよい。

【0131】一般式(III)におけるBは、一般式(V I)におけるZを含む有橋式脂環式環構造を構成する炭 40 素原子のいずれの位置で結合してもよい。

【0132】以下に、一般式(VI)で表される構造を有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定されるものではない。

[0133]

【化70】

97

[0134]

(

【0135】さらに、式(III)におけるR92が下記の一般式(VII)で表される構造を有する繰り返し構造単位について説明する。

[0136] 【化72】

50

【0137】一般式 (VII) において、R1d~R8dは、各々独立に、水素原子または鎖状アルキル基を表す。Rd0は、水素原子あるいは、鎖状又は環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。mは、1~10の整数を表す。

【0138】一般式 (VII) におけるRia~Rea、Rao の鎖状アルキル基としては、直鎖状、分岐状あるいは環 状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよ い。直鎖状、分岐状のアルキル基としては、炭素数1~ 12個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、 より好ましくは炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐 状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソ ブチル基、secーブチル基、tーブチル基、ペンチル 基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、 デシル基である。Raoの環状のアルキル基としては、炭 素数3~30個のものが挙げられ、具体的には、シクロ プロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ア ダマンチル基、ノルボルニル基、ボロニル基、トリシク ロデカニル基、ジシクロペンテニル基、ノボルナンエポ キシ基、メンチル基、イソメンチル基、ネオメンチル 基、テトラシクロドデカニル基、ステロイド残基等を挙 げることができる。

【0139】R_{do}のアリール基としては、炭素数6~2 0個のものが挙げられ、置換基を有していてもよい。具* *体的にはフェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。Rdoのアラルキル基としては、炭素数7~20個のものが挙げられ、置換基を有していてもよい。ベンジル基、フェネチル基、クミル基等が挙げられる。本発明において、Rtd~Rddとしては、水素原子、メチル基が好ましい。Rdoとしては、水素原子、炭素数1~4個のアルキル基が好ましい。mは、1~6が好ましい。

【0140】上記鎖状又は環状アルキル基、アリール 基、アラルキル基、アルキレン基、環状アルキレン基、 アリーレン基における更なる置換基としては、カルボキ シル基、シアノ基、水酸基、ハロゲン原子(例えば塩素 原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等)、アルキル 基、置換アルキル基、アルコキシ基(好ましくは炭素数 1~4、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、プトキシ基等)、アルコキシカルボニル基、アシル 基、アシルオキシ基(例えばアセトキシ基)、アセチル アミド基が挙げられる。ここでアルキル基としては、メ チル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチ ル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペン チル基等の低級アルキル基を挙げることができる。置換 アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、 アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4)を挙げること ができる。

【0141】以下に、一般式(VII)で表される構造を 有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定 されるものではない。

【0142】 【化73】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ -\left(\text{CH}_{2} - \text{C}\right) \\ \text{C} \\ \text{C} \\ -\text{O} - \text{CH}_{2}\text{CH}_{2} - \text{O} - \text{CH}_{2}\text{CH}_{2} - \text{O} - \text{CH}_{3} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} - \left(CH_{2} - \stackrel{H}{C} \right) \\ - \left(CH_{2} - \stackrel{H}{C} \right) \\ - \left(CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{3} \right) \\ - \left(CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{3} \right) \\ - \left(CH_{2} - \frac{1}{C} \right) \\ - \left(CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{3} \right) \\ - \left(CH_{2} - \frac{1}{C} \right) \\ - \left(CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{3} \right) \\ - \left(CH_{2} - \frac{1}{C} \right) \\ - \left(CH_{$$

【0143】 【化74】

50 [0144]

102

[0145]

[0146]

[4
$$t$$
 7]

CH₃

(CH₂- t)

O= t

NH

C-O-CH₂CH₂-O-CH₂CH₂-O-CH₃

[0147]

[
$$\{\text{th } 7 \ 8 \}]$$
 $-(\text{CH}_2 - \text{C}_2)$
 $O = \text{C}$
 $O = \text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{O}_2\text{CH}_2 - \text{O}_2\text{CH}_3}$
 $O = \text{CH}_2\text{CH}_2 - \text{O}_2\text{CH}_3$

【0148】次に、式(III)におけるRe2が下記の一般式(VIII)で表される構造を有する繰り返し構造単位について説明する。

 $-N^{+}(R_{95})(R_{96})(R_{97}) \cdot X^{-} (VIII)$

【0149】一般式(VIII)中: R95~R97は、各々独立に、水素原子、鎖状または環状アルキル基、アルケニル基、アリール基、又はアラルキル基を表す。但し、R95~R97は互いに結合して非芳香環、芳香環を形成しても良い。鎖状アルキル基としては、直鎖状あるいは分岐状のアルキル基が挙げられ、置換基を有していてもよい。炭素数1~12個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、nープチル基、イソプチル基、secープチル基、ペンチル

基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基である。

【0150】環状のアルキル基としては、炭素数3~3 0個のものが挙げられ、酸素原子、窒素原子等のヘテロ 40 原子を含んでいてもよい。具体的には、シクロプロピル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチ ル基、ノルボルニル基、ボロニル基、トリシクロデカニ ル基、ジシクロペンテニル基、ノボルナンエポキシ基、 メンチル基、イソメンチル基、ネオメンチル基、テトラ シクロドデカニル基、ステロイド残基、テトラヒドロピ ラニル基、モルホリノ基等を挙げることができる。

基が好ましく、より好ましくは炭素数1~10個の直鎖 状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ましくはメ チル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソプチル基、sec-ブチル基、ペンチル 50 ル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、シクロペンテニル

基、シクロヘキセニル基、3ーオキソシクロヘキセニル 基、3ーオキソシクロペンテニル基、3ーオキソインデ ニル基等が挙げられる。これらのうち環状のアルケニル 基は酸素原子を含んでいてもよい。アリール基として は、炭素数6~10個のものが挙げられ、置換基を有し ていてもよい。具体的にはフェニル基、トリル基、ナフ チル基等が挙げられる。

【0152】アラルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基、ナフチルエチル基、メシチルメチル基を挙げることができる。

【0153】Ros~Rorとしての鎖状又は環状アルキル 基、アルケニル基、アリール基、又はアラルキル基、及 びR95~R97が結合して形成してもよい非芳香環、芳香 環が有していてもよい置換基としては、例えば、カルボ キシル基、シアノ基、水酸基、ハロゲン原子(塩素原 子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等)、アルコキシ 基(好ましくは炭素数1~4、例えばメトキシ基、エト キシ基、プロポキシ基、ブトキシ基)、アセチルアミド 基、アルコキシカルボニル基、アシル基(好ましくは炭 素数2~10、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロ ピオニル基)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数2~ 10、例えばアセトキシ基)、アリール基(好ましくは 炭素数6~14、例えばフェニル基) が挙げられる。R 95~R97としてのアリール基又はアラルキル基及びR95 ~R97が結合して形成してもよい非芳香環、芳香環につ いては、置換基として、アルキル基(好ましくは炭素数 1~5、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソ プロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチ ル基、シクロペンチル基等)を有していてもよい。この 置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原 30 子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4、例えばメ トキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基)等 の置換基を有していてもよい。

【0154】X-は、上記のように特定の構造R-SO3

104

を有する。Rの脂肪族炭化水素基は、好ましくは炭素数1~20個の直鎖あるいは分岐アルキル基又は環状のアルキル基であり、置換基を有していてもよい。また、Rの芳香族炭化水素基は、好ましくは炭素数6~14の芳香族基であり、置換基を有していてもよい。

【0155】上記のRのアルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、nープチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、ドデシル基 10 等が挙げられ、環状アルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基、シクロドデシル基、アダマンチル基、ノルボルニル基、樟脳基、トリシクロデカニル基、メンチル基等を挙げることができる。芳香族基としては、置換基を有してもよい、フェニル基、ナフチル基等を挙げることができる。

【0156】上記脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基が有してもよい置換基としては、例えば、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、樟脳基等が挙げられ、具体的には、メチル基、tープチル基、メトキシ基、エトキシ基、 tープトキシ基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、シアノ基、水酸基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、 tープトキシカルボニル基、 tーアミロキシカルボニル基等が挙げられる。更に、脂肪族炭化水素基については、アリール基(好ましくは炭素数6~14)、芳香族炭化水素基についてはアルキル基(炭素数1~15)を置換基として挙げることができる。

【0157】以下、一般式(VIII)で表される構造を 有する繰り返し単位の具体例を示す。しかし、本発明の 内容がこれらに限定されるものではない。

【0158】 【化79】

特開2002-341539

106

$$-CH_{2}-\overset{\Pi}{C}-C - CH_{3} \\ \overset{\downarrow}{C}-O-CH_{2}CH_{2}-\overset{\downarrow}{N}-CH_{2}CH_{3} \\ \overset{\downarrow}{C}-CH_{3}CH_{2}-\overset{\downarrow}{N}-CH_{2}CH_{3} \\ \overset{\downarrow}{C}-CH_{3}CH_{3} \\ \overset{\downarrow}{C}-CH_{3} \\ \overset{\downarrow}{C}-CH_{$$

[0159]

【化80】

特開2002-341539

$$-CH_{2}-C - CH_{3} CH_{3} CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{3}-CH$$

$$-CH_{2}-\stackrel{C}{C}- \qquad CH_{3} \\ \stackrel{C}{C}-O-CH_{2}CH_{2}-\stackrel{N}{N}-CH_{2}- \qquad CF_{3}SO_{3}^{-} \qquad (8)$$

$$-CH_{2} - C - CH_{3} CH_{3} CF_{3}SO_{3} (9)$$

$$C - CH_{2}CH_{2} - N + CF_{3}SO_{3} (9)$$

$$-CH_{2}-\overset{1}{C}-\overset{C}{C}-\overset{C}{C}-\overset{C}{C}+\overset{C}{3}$$

$$\overset{1}{C}-O-CH_{2}CH_{2}-\overset{1}{N}-CH_{3}$$

$$\overset{1}{C}-\overset{$$

$$-CH_{2}-\overset{H}{C}-\overset{C}{C}-\overset{C}{C}-\overset{C}{C}-\overset{C}{C}+\overset{C}$$

[0160]

【化81】

特開2002-341539

$$-CH_{2}-C-- CH_{3} CH_{3} CH_{3}(CH_{2})_{7}SO_{3}^{-} (16)$$

$$-CH_{2}CH_{2}-N-CH_{2}CH_{3} CH_{3}(CH_{2})_{7}SO_{3}^{-} (16)$$

$$-CH_{2}CH_{2}-N-CH_{2}CH_{3} CH_{3}(CH_{2})_{7}SO_{3}^{-} (16)$$

$$-CH_{2}-C - CH_{2}CH_{3} - CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{2}CH_{3} - CF_{3}SO_{3}^{-}$$

$$C - CH_{2}CH_{2}CH_{2}-N - CH_{2}CH_{3} - CF_{3}SO_{3}^{-}$$

$$CH_{2}CH_{3} - CH_{2}CH_{3} - CH_{2}CH_{3}$$

[0161]

【化82】

特開2002-341539

[0162]

【0163】さらに、式 (III) におけるR92が下記の 一般式(IX)又は(X)で表される構造を有する繰り 返し構造単位について説明する。

 $-R_{98}-A_{50}-R_{99}$ (IX)

- S O3 R100 (X)

【0164】一般式 (IX) 中、Rssは、単結合、アル キレン基、アリーレン基、又はこれらを組み合わせた2 価の基を表す。アリーレン基としては、炭素数6~10 のものが挙げられ、置換基を有していてもよい。具体的 にはフェニレン基、トリレン基、ナフチレン基等が挙げ られる。

を挙げることができる。

40 - [C (R f)(R g)]r-

式中、Rf、Rg:水素原子、アルキル基、置換アルキ ル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両 者は同一でも異なっていてもよく、アルキル基としては メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、ブ チル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくは メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基より なる群から選択された置換基を表す。置換アルキル基の 置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基 を挙げることができる。アルコキシ基としてはメトキシ 【0165】アルキレン基としては、下記で示される基 50 基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等の炭素数

1~4個のものを挙げることができる。 r は 1~10の 整数を表す。上記において、ハロゲン原子としては塩素 原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げること ができる。

【0166】Asoは、下記に示す官能基のいずれかを表 す。

【0168】R99は、水素原子又はアルキル基を表す。R99の鎖状アルキル基は、直鎖状、分岐状いずれでもよく、また置換基を有していてもよい。直鎖状あるいは分岐状のアルキル基としては、炭素数1~12のものが好ましく、より好ましくは炭素数1~10のものであり、具体的にメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ローブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tープチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基を好ましく挙げることができる。

【0169】一般式(X)におけるR100は、鎖状又は環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表し、置換基を有していてもよい。R100の鎖状アルキル基は、直鎖状、分岐状いずれでもよく、置換基を有していてもよい。直鎖状あるいは分岐状のアルキル基としては、炭素数1~12のものが好ましく、より好ましくは炭素数1~10のものであり、具体的にメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープチル基、イソプチル基、secープチル基、tープチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘブチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基を好ましく挙げることができる。R100の環状のアルキル基としては、炭素数3~30のものが挙げられ、具体的には、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基、ノルボルニル基、ジクロヘキシル基、ドリシクロデカニル基、ジシクロペ

114

ンテニル基、ノボルナンエポキシ基、メンチル基、イソメンチル基、ネオメンチル基、テトラシクロドデカニル基、ステロイド残基等を挙げることができる。環構造は、ヘテロ原子、2重結合を有していてもよい。このような例として、テトラヒドロピラン、ペンテン環を挙げることができる。

【0170】R100のアリール基としては、炭素数6~20のものが挙げられ、置換基を有していてもよい。具体的にはフェニル基、トリル基、ナフチル基等が挙げられる。R100のアラルキル基としては、炭素数7~20のものが挙げられ、置換基を有していてもよい。具体的には、ベンジル基、フェネチル基、クミル基等が挙げられる。

【0171】Rooの鎖状アルキル基、Riooの鎖状又は 環状アルキル基、アルコキシ基、アリール基、又はアラ ルキル基が有していてもよい置換基としては、例えば、 カルボキシル基、シアノ基、水酸基、ハロゲン原子(塩 素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等)、アルコ キシ基(好ましくは炭素数1~4、例えばメトキシ基、 エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基)、アセチルア ミド基、アルコキシカルボニル基、アシル基(好ましく は炭素数2~10、例えば、ホルミル基、アセチル基、 プロピオニル基)、アシルオキシ基(好ましくは炭素数 2~10、例えばアセトキシ基)、アリール基(好まし くは炭素数6~14、例えばフェニル基)が挙げられ る。R100としてアリール基又はアラルキル基について は、置換基として、更にアルキル基(好ましくは炭素数 1~5、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソ プロピル基、プチル基、シクロプロピル基、シクロブチ 30 ル基、シクロペンチル基等)を有していてもよい。この 置換基としてのアルキル基は、更に水酸基、ハロゲン原 子、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4、例えばメ トキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基) 等 の置換基を有していてもよい。尚環構造は、縮合環を形 成してもよい。

【0172】以下、 $-NH-SO_2-$ を含有する一般式 (III)で表される繰り返し単位に対応するモノマーの具体例 (2) \sim (5)、及び、一般式 (IX)で示される構造を有する繰り返し構造単位に相当するモノマーの具体例 (6) \sim (15)を示すが、これらに限定されるものではない。

【0173】 【化85】

特開2002-341539

116

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} \\ \text{CH}_2 = \text{CH} \\ \text{C} - \text{NH} - \text{SO}_2 - \text{CH}_3 \end{array} (2) \begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{C} \\ \text{C} - \text{NH} - \text{SO}_2 - \text{CH}_3 \end{array} (3) \\ \text{C} - \text{NH} - \text{SO}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} \\ | \\ | \\ \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2 \text{CH}_2 - \text{SO}_2 - \text{NH} - \text{SO}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$$
 (7)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} \\ | \\ | \\ | \\ | \\ \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{CH}_2 - \text{SO}_2 - \text{NH} - \text{SO}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3)_2} \end{array}$$
 (8)

[0174]

【化86】

117

$$CH_2 = CH$$

$$C - O - CH_2CH_2 - SO_2 - NH - SO_2 - CH_3$$
(10)

$$CH_{2} = CH$$

$$C - O - CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - NH - SO_{2}$$

$$O$$
(11)

$$CH_2 = CH$$
|
| C-O-CH₂CH₂-NH-C-NH-SO₂-CH₃ (12)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} \\ | \\ | \\ | \\ \text{C-O-CH}_2\text{CH}_2 - \text{NH} - \text{C--NH} - \text{SO}_2 - \text{CH}_2(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3 \\ | \\ | \\ | \\ \text{O} \end{array}$$

$$CH_{2} = CH$$

$$C - O - CH_{2}CH_{2} - NH - C - NH - SO_{2} - O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

[0175]

【0176】以下、一般式(X)で表される構造を有する繰り返し構造単位に相当するモノマーの具体例を示すが、これらに限定されるものではない。

[0177]

【化88】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{2} = \text{CH} & \text{CH}_{3} \\ \text{C} - \text{O} - \text{CH}_{2} \text{CH}_{2} - \text{SO}_{2} - \text{O} - \text{CH} - \text{CH}_{2} \text{OCH}_{3} \end{array} \tag{1}$$

$$\text{CH}_{2} = \text{CH} & \text{CH}_{3} \\ \text{CH}_{2} = \text{CH} & \text{CH}_{3} \end{array}$$

$$CH_{2} = CH$$

$$C - O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O - O$$
(4)

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 = CH & \\
C - O - CH_2CH_2CH_2 - SO_2 - O
\end{array}$$
(5)

[0178]

特開2002-341539

122

$$\begin{array}{cccc} CH_{2} = CH & CH_{3} \\ & | & CH_{3} \\ & | & C-O-CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O - CH - CH_{2}CI \end{array} \tag{10}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 = CH & (12) \\
C - O - CH_2CH_2 - SO_2 - O - O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{CH} & \text{CH}_3 \\ \downarrow & \text{C} - \text{O} - \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{CH}_2 - \text{SO}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \downarrow & \text{O} \end{array} \tag{14}$$

[0179]

30 【化90】

$$CH_{2} = CH$$

$$C - O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O$$
(15)

$$\begin{array}{c} CH_{2} = CH \\ \vdots \\ C-O-CH_{2}CH_{2}-SO_{2}-O \end{array}$$
(16)

$$CH_{2} = CH$$

$$C - O - CH_{2}CH_{2}CH_{2} - SO_{2} - O$$
O

$$\begin{array}{c|c}
CH_2 = CH & CI \\
C - O - CH_2CH_2CH_2 - SO_2 - O - CI \\
C - O - CH_2CH_2CH_2 - SO_2 - O - CI
\end{array}$$
(19)

【0180】本発明で使用される酸分解性樹脂は、更に、下記式(XI)で表される繰り返し単位を含有することもできる。

[0181]

【化91】

【0182】一般式(XI)に関して、Roic、X5c、 Roic、Bcは、各々、上記一般式(III)についての Roi、X5、Roi、Bと同様である。Roicは下記一般式 (XI')で表される基を表す。

[0183]

【化92】

$$R_{2c}$$
 R_{4c} R_{4c} R_{3c}

【0184】一般式 (XI') において、R2c~R4c は、各々独立に水素原子又は水酸基を表す。ただし、R 2c~R4cのうち少なくとも1つは水酸基を表す。

【0185】一般式 (XI) で表される構造は、好まし 50

くはジヒドロキシ体、モノヒドロキシ体であり、より好ましくはジヒドロキシ体である。

【0186】以下に、一般式(XI)で表される構造を 有する繰り返し単位の具体例を挙げるが、これらに限定 30 されるものではない。

[0187]

【化93】

$$-CH2-CH-OHOH$$
(1)

[0188] 【化94】

40

$$-CH_2$$
 $-CH_2$
 $-CH_3$
 $-CH_2$
 $-CH_3$
 $-CH_$

【0189】本発明に係わる樹脂において、酸分解性基 の構造は、例えば、-C (=O) $-X_1-R_0$ で表され る。式中、Ro としては、tープチル基、tーアミル基 等の3級アルキル基、イソボロニル基、1-エトキシエ チル基、1-プトキシエチル基、1-イソプトキシエチ ル基、1-シクロヘキシロキシエチル基等の1-アルコ キシエチル基、1-メトキシメチル基、1-エトキシメ チル基等のアルコキシメチル基、3-オキソアルキル 基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロフラニル 基、トリアルキルシリルエステル基、3-オキソシクロ ヘキシルエステル基、2-メチル-2-アダマンチル 基、メバロニックラクトン残基等を挙げることができ る。X1は、酸素原子、硫黄原子、-NH-、-NHS O₂ - 、又は-NHSO₂NH-を表す。本発明に係わる 樹脂に於いては、下記一般式(a)で示される酸分解性 基がより好ましく、一般式(b)で示される酸分解性基 が特に好ましい。

【0190】 【化95】

$$-COO - R_{3a}$$
 (a)

【0191】上記構造中、R10~R30は、各々独立に、メチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、シクロヘキシル基、アダマンチル等のアルキル基を表す。このような酸分解性基を有するモノマーとしては、例えば、一般式(III)で示される繰り返し構造単位に相当するモノマーとして挙げた前記5、6、7、8、9、10、27、28、29等を挙げることができる。また、このような酸分解性基を有する繰り返し構造単位としては、例えば、一般式(II-A)及び一般式(II-B)で表される繰返し構造単位として挙げた前記II-6~II-8、II-11、II-12、II-16~II-19、II-21、

| | | -23~ | | -26、 | | -29、 | | -30、 | | -41、 | | -46、 | | -50~ | | -52、 | | -58、 | | -61、 | | -81、 | | -113、 | | -167、 | | -169~ | | -171等を挙げることができる。

【0192】本発明に係る樹脂においては、酸分解性基は、前記一般式(I)で示される脂環式炭化水素を含む部分構造を有する繰り返し構造単位、一般式(III)で表される繰り返し構造単位、及び後記共重合成分の繰り返し単位のうち少なくとも1種の繰り返し単位に含有10 することができる。

【0193】(A)成分である酸分解性樹脂は、上記の繰り返し構造単位以外に、ドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要な特性である解像力、耐熱性、感度等を調節する目的で様々な繰り返し構造単位を含有することができる。

【0194】このような繰り返し構造単位としては、下 記の単量体に相当する繰り返し構造単位を挙げることが できるが、これらに限定されるものではない。これによ 20 り、酸分解性樹脂に要求される性能、特に、

- (1) 塗布溶剤に対する溶解性、
 - (2) 製膜性(ガラス転移点)、
 - (3) アルカリ現像性、
 - (4) 膜べり (親疎水性、アルカリ可溶性基選択)、
 - (5) 未露光部の基板への密着性、
 - (6) ドライエッチング耐性

等の微調整が可能となる。このような単量体として、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等を挙げることができる。

【0195】具体的には、以下の単量体を挙げることができる。

アクリル酸エステル類 (好ましくはアルキル基の炭素数が1~10のアルキルアクリレート):アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ーtーオ40 クチル、クロルエチルアクリレート、2ーヒドロキシエチルアクリレート2,2ージメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等。

【0196】メタクリル酸エステル類(好ましくはアルキル基の炭素数が1~10のアルキルメタアクリレート):メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、50 プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレー

ト、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレート、4ーヒドロキシブチルメタクリレート、5ーヒドロキシペンチルメタクリレート、2,2ージメチルー3ーヒドロキシブロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等。

【0197】アクリルアミド類: アクリルアミド、Nーアルキルアクリルアミド (アルキル基としては炭素数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、プチル基、 tープチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基等がある。)、N, Nージアルキルアクリルアミド (アルキル基としては炭素数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、プチル基、イソプチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基等がある)、NーヒドロキシエチルーNーメチルアクリルアミド、Nー2ーアセトアミドエチ 20ルーNーアセチルアクリルアミド等。

【0198】メタクリルアミド類:メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド (アルキル基としては炭素数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、tープチル基、エチル本シル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基等がある)、N,N-ジアルキルメタクリルアミド (アルキル基としてはエチル基、プロピル基、プチル基等がある)、N-ヒドロキシエチルーNーメチルメタクリルアミド等。

【0199】アリル化合物:アリルエステル類(例えば 30 酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリル等)、アリルオキシエタノール等。

【0200】ビニルエーテル類:アルキルビニルエーテル(例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、アシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1ーメチルー2,2ージメチルプロピルビニルエーテル、2ーエチルプチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ブナルアミノエチルビニルエーテル、バンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル等。

【0201】ビニルエステル類:ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルア 50

セテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニルーβーフェニルブチレート、ビニルシクロへキシルカルボキシレート等。

【0202】イタコン酸ジアルキル類:イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチル等。フマール酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエステル類;ジブチルフマレート等。

【0203】その他クロトン酸、イタコン酸、無水マレ 10 イン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニ トリル、マレイロニトリル等。

【0204】その他にも、上記種々の繰り返し構造単位 に相当する単量体と共重合可能である付加重合性の不飽 和化合物であれば、共重合されていてもよい。

【0205】酸分解性樹脂において、各繰り返し構造単位の含有モル比はレジストのドライエッチング耐性や標準現像液適性、基板密着性、レジストプロファイル、さらにはレジストの一般的な必要性能である解像力、耐熱性、感度等を調節するために適宜設定される。

【0206】酸分解性樹脂中、一般式(I)で表される 繰り返し単位の含有量は、全繰り返し構造単位中10~ 60モル%が好ましく、より好ましくは15~55モル %、更に好ましくは20~50モル%である。酸分解性 樹脂中、一般式 (II)で表される繰り返し単位の含有 量は、全繰り返し構造単位中10~70モル%が好まし く、より好ましくは15~60モル%、更に好ましくは 20~50モル%である。酸分解性樹脂中、一般式(I II)で表される繰り返し単位の含有量は、全繰り返し 構造単位中2~80モル%が好ましく、より好ましくは 4~70モル%、更に好ましくは6~60モル%であ る。式(I)または式(III)の繰り返し単位が酸分解性 基を有する場合を含む酸分解性基を有する繰り返し単位 の含有量は、全繰り返し構造単位中15~90モル%が 好ましく、より好ましくは15~85モル%、更に好ま しくは20~80モル%である。

【0207】本発明に用いる酸分解性樹脂は、常法に従って(例えばラジカル重合)合成することができる。例えば、一般的合成方法としては、モノマー種を、一括であるいは反応途中で反応容器に仕込み、これを必要に応じ反応溶媒、例えばテトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ジイソプロピルエーテルなどのエーテル類やメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、酢酸エチルのようなエステル溶媒、さらには後述のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートのような本発明の組成物を溶解する溶媒に溶解させ均一とした後、窒素やアルゴンなど不活性ガス雰囲気下で必要に応じ加熱、市販のラジカル開始剤(アゾ系開始剤、パーオキサイドなど)を用いて重合を開始させる。所望により開始剤を追加、あるいは分割で添加し、反応終了後、溶剤に投入して粉体あるいは固形回収等の方法

で所望のポリマーを回収する。反応の濃度は20重量%以上であり、好ましくは30重量%以上、さらに好ましくは40重量%以上である。反応温度は10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 150 $^{\circ}$ 0であり、好ましくは30 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 120 $^{\circ}$ 0、さらに好ましくは50 $^{\circ}$ 100 $^{\circ}$ 0である。

【0208】本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは1,000~200,000である。重量平均分子量が1,000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣化が見られるため余り好ましくなく、200,000を越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるため製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じる。本発明の組成物がArF露光用であるとき、ArF光への透明性の点から樹脂は芳香環を有しないことが好ましい。

【0209】本発明の遠紫外線露光用ポジ型フォトレジスト組成物において、本発明に係わる全ての樹脂の組成物全体中の配合量は、全レジスト固形分中40~99.99重量%が好ましく、より好ましくは50~99.97重量%である。

【0210】〔2〕(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)本発明で用いられる光酸発生剤は、前記一般式(Ia)又は一般式(IIb)で表される化合物である。一般式(Ia)及び(IIb)に於いて、 $R_1 \sim R_5$ は、各々独立に、置換基を有していてもよい脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基を表す。但し、 $R_1 \sim R_3$ の内の2個は、互いに結合して環を形成してもよく、また、 R_4 と R_5 とは、互いに結合して環を形成してもよい。 X^- は、前記アニオンのいずれかを表す。前記アニオンに於いて、 $R_6 \sim R$ 10は、各々独立に、脂肪族炭化水素基を表す。但し、 R_6 と R_7 とは、互いに結合して環を形成してもよく、また、 $R_8 \sim R_{10}$ の内の2個は、互いに結合して環を形成してもよく、また、 $R_8 \sim R_{10}$ の内の2個は、互いに結合して環を形成してもよい。

【0211】R1~R5の脂肪族炭化水素基としては、例えば、置換基を有していてもよい、炭素数1~15の飽和脂肪族炭化水素基、脂環式脂肪族炭化水素基を挙げることができる。飽和脂肪族炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基等を挙げることができ、不飽和脂肪族炭化水素基としては、例えば、ビニル基、ブロペニル基、アリル基、イソプロペニル基、ブテニル基等を挙げることができ、脂環式脂肪族炭化水素基としては、例えば、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基を挙げることができる。

【0212】上記飽和脂肪族炭化水素基、不飽和脂肪族 50 ロビル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプチル基、

炭化水素基及び脂環式脂肪族炭化水素基は、置換基を有 していてもよく、例えば、カルポキシル基、シアノ基、 アルキル基(好ましくは炭素数1~12)、置換アルキ ル基(好ましくは炭素数1~12)、ハロゲン原子、水 酸基、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~12)、ア セチルアミド基、アルコキシカルボニル基(好ましくは 炭素数1~12)、アシル基(好ましくは炭素数1~1 2) 、フェニルチオ基、ニトロ基、アシルオキシ基(好 ましくは炭素数1~12) 等を挙げることができる。こ こでアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプ ロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基等を挙げ ることができる。置換アルキル基の置換基としては、水 酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基等を挙げることがで きる。アルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エ トキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等を挙げることが できる。アシルオキシ基としては、例えば、アセトキシ 基等を挙げることができる。ハロゲン原子としては、例 えば、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素原子等を 20 挙げることができる。

【0213】R1~R5の芳香族炭化水素基としては、例 えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナ ントリル基、9-フルオレニル基等を挙げることができ る。R1~R5としては、フェニル基が特に好ましい。 【0214】上記芳香族炭化水素基は、置換基を有して いてもよく、例えば、カルボキシル基、シアノ基、アル キル基(好ましくは炭素数1~12)、置換アルキル基 (好ましくは炭素数1~12)、ハロゲン原子、水酸 基、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~12)、アセ 30 チルアミド基、アルコキシカルボニル基(好ましくは炭 素数1~12)、アシル基(好ましくは炭素数1~1 2) 、フェニルチオ基、ニトロ基、アシルオキシ基(好 ましくは炭素数1~12) 等を挙げることができる。こ こでアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、シクロプ ロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基等を挙げ ることができる。置換アルキル基の置換基としては、例 えば、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基等を挙げる ことができる。アルコキシ基としては、例えば、メトキ シ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等を挙げ ることができる。アシルオキシ基としては、例えば、ア セトキシ基等を挙げることができる。ハロゲン原子とし ては、例えば、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、沃素 原子等を挙げることができる。

【0215】R6~R10の脂肪族炭化水素基としては、例えば、置換基を有していてもよい、炭素数1~15の飽和脂肪族炭化水素基、不飽和脂肪族炭化水素基、脂環式脂肪族炭化水素基を挙げることができる。飽和脂肪族炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロビル其、インプロビル其、ブチル基、インプチル其

sec-プチル基、tert-プチル基、ペンチル基、イソペン チル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オ クチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシ ル基等を挙げることができ、不飽和脂肪族炭化水素基と しては、例えば、ピニル基、プロペニル基、アリル基、 イソプロペニル基、プテニル基等を挙げることができ、 脂環式脂肪族炭化水素基としては、例えば、シクロプロ ピル基、シクロプチル基、シクロペンチル基を挙げるこ とができる。Re~Rioとしては、炭素数1~5の飽和 脂肪族炭化水素基が特に好ましい。

【0216】上記飽和脂肪族炭化水素基、不飽和脂肪族 炭化水素基及び脂環式脂肪族炭化水素基は、更なる置換 基を有していてもよく、例えば、カルボキシル基、シア ノ基、アルキル基(好ましくは炭素数1~5)、置換ア ルキル基(好ましくは炭素数1~5)、ハロゲン原子、 水酸基、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~5)、ア セチルアミド基、アルコキシカルボニル基(好ましくは 炭素数1~5)、アシル基(好ましくは炭素数1~ 5)、ニトロ基、アシルオキシ基(好ましくは炭素数1 ~5) 等を挙げることができる。ここでアルキル基とし 20 ては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソ プロピル基、ブチル基、シクロプロピル基、シクロブチ ル基、シクロペンチル基等を挙げることができる。置換 アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、 アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基と しては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ 基、プトキシ基等を挙げることができる。アシルオキシ 基としては、例えば、アセトキシ基等を挙げることがで きる。ハロゲン原子としては、例えば、塩素原子、臭素 原子、フッ素原子、沃素原子等を挙げることができる。 R6~R10としての飽和脂肪族炭化水素基、不飽和脂肪 族炭化水素基及び脂環式脂肪族炭化水素基が有していて もよい置換基としては、フッ素原子、塩素原子、ニトロ

基、シアノ基、アルコキシカルポニル基、アシルオキシ 基、アシル基等の電子吸引性基がより好ましく、フッ素 原子が特に好ましい。

【0217】R₁~R₃の内の2個が結合して形成する環 としては、例えば、1個の硫黄原子を含む炭素数3~6 の環を挙げることができる。R4とR5が結合して形成す る環としては、例えば、1個の沃案原子を含む炭素原子 数3~6の環を挙げることができる。ReとRiが結合し て形成する環としては、例えば、1個の窒素原子及び2 個の硫黄原子を含む炭素原子数3~6の環を挙げること ができる。R8~R10の内の2個が結合して形成する環 としては、例えば、2個の硫黄原子を含む炭素数3~6 の環を挙げることができる。

【0218】一般式(Ia)で表される化合物は、硫黄 原子を介して2個のカチオンが結合した構造とされてい てもよい。

【0219】一般式(Ia)又は一般式(IIb)で表 される化合物の添加量は、組成物中の固形分を基準にし て、通常0.001~30重量%の範囲で用いられ、好 ましくは0.3~20重量%、更に好ましくは0.5~ 10重量%の範囲で使用される。添加量が0.001重 量%より少なと本発明の効果が十分でない場合があり、 30重量%より多いとプロファイルが劣化し解像性能が 低下する傾向にある。一般式(Ia)又は一般式(II b) で表される化合物は、例えば対応するアニオンを有 する塩と対応するカチオンを有する塩(例えば、臭化ス ルフォニウム塩) との塩交換により合成することができ

【0220】以下に、一般式(Ia)及び一般式(II b) で表される化合物の具体例を挙げるが、本発明はこ れらに限定されるものではない。

[0221]

【化96】

$$F_{3}C - SO_{2} - \bar{N} - SO_{2} - CF_{3} \qquad [Ia-1]$$

$$F_{3}CF_{2}C - SO_{2} - \bar{N} - SO_{2} - CF_{2}CF_{3} \qquad [Ia-2]$$

$$F_{3}CF_{2}C - SO_{2} - \bar{N} - SO_{2} - CF_{2}CF_{3} \qquad [Ia-2]$$

$$F_{3}C(F_{2}C)_{3} - SO_{2} - \bar{N} - SO_{2} - (CF_{2})_{3}CF_{3} \qquad [Ia-3]$$

$$F_{3}C - SO_{2} - \bar{N} - SO_{2} - CF_{3} \qquad [Ia-4]$$

[0222]

【化97】

$$H_{3}CO - \bigcirc -S^{+} \qquad F_{3}C - SO_{2} - \bar{N} - SO_{2} - (CF_{2})_{3}CF_{3} \qquad [Ia-6]$$

$$+ \bigcirc -S^{+} \qquad H_{3}CH_{2}C - SO_{2} - \bar{N} - SO_{2} - (CF_{2})_{3}CF_{3} \qquad [Ia-7]$$

$$O_{2}$$

$$\begin{array}{c|cccc}
 & O_2 \\
 & \bar{N} & CF_2 \\
 & O_2S & CF_2 \\
 & F_2
\end{array} \quad [Ia-8]$$

[0223]

【化98】

138

$$F_{3}C-SO_{2}-\bar{C}-SO_{2}-CF_{3}$$

$$SO_{2}$$

$$CF_{3}$$

$$[Ia-10]$$

$$F_{3}CF_{2}C-SO_{2}-\bar{C}-SO_{2}-CF_{2}CF_{3}$$

$$[Ia-11]$$

[0224]

【化99】

特開2002-341539

139

HO
$$F_3$$
C(F_2 C)₃ F_3 C(F_3 C)

$$S^{+}$$
 $F_3C-SO_2-N-SO_2-CF_3$ [Ia-17]

$$S-S-S-S-S-SO_2-N-SO_2-CF_3$$
 [Ia-18]

[0225]

【化100】

特開2002-341539

[Ia-19]

$$\begin{array}{c|cccc}
\hline
 & & & & & \\
 & \downarrow & & & & \\
 & \downarrow & & & & \\
 & \downarrow & \downarrow & & \\
 & \downarrow & & & \\
 & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow &$$

$$S^{+}$$
 $F_3CF_2C-SO_2-N-SO_2-CF_2CF_3$ [Ia-21]

$$S^{+}$$
 $F_3C-SO_2-N-SO_2-(CF_2)_3CF_3$ [Ia-23]

[0226]

【化101】

特開2002-341539

H₃C(H₂C)₂H₂COOC COOCH₂(CH₂)₂CH₃

$$CH_2(CH_2)_6CH_3$$

$$F_3C-SO_2-N-SO_2-(CF_2)_3CF_3$$
[IIb-6]

[0227]

30 【化102】

$$F_3CF_2C - SO_2 - \overline{C} - SO_2 - CF_2CF_3$$

$$SO_2 \qquad [IIb-7]$$

$$CF_2CF_3$$

$$F_3C(F_2C)_3 - SO_2 - \bar{C} - SO_2 - \bar{C}$$

【0228】本発明に於いては、一般式(Ia)又は一般式(IIb)で表される化合物とともに他の光酸発生剤を併用してもよい。併用してもよい光酸発生剤の添加量は、一般式(Ia)又は一般式(IIb)で表される化合物の総量に対し、通常200重量%以下、好ましくは1500重量%以下、特に好ましくは1000重量%以下である。本発明で併用してもよい光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0229】また、その他の本発明で併用してもよい光酸発生剤としては、たとえばジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウ 40 ム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化 *

きる。また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物を用いることができる。
 【0230】さらにV.N.R.Pillai,Synthesis,(1),1(1980)、A.Abad etal,Tetrahedron Lett.,(47)4555(1971)、D.H.R.Barton etal,J.Chem.Soc.,(C),329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光

【0231】上記活性光線又は放射線の照射により分解 して酸を発生する化合物の中で、特に有効に併用される ものについて以下に説明する。

により酸を発生する化合物も使用することができる。

[8-d11]

*物、o-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、

イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホ

ン酸を発生する化合物、ジスルホン化合物、ジアゾケト

スルホン、ジアゾジスルホン化合物等を挙げることがで

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式(PAG1)で表されるオキサゾール誘導体又は一般式(PAG2)で表されるSートリアジン誘導体。

[0232]

【化103】

PAG1)

【0233】式中、 R^{201} は置換もしくは未置換のアリ アリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y)3 ール基、アルケニル基、 R^{202} は置換もしくは未置換の 50 をしめす。Yは塩素原子又は臭素原子を示す。具体的に

148

は以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定さ * 【0234】 れるものではない。 * 【化104】

【0235】 (2) 下記の一般式 (PAG3) で表されるヨードニウム塩、又は一般式 (PAG4) で表されるスルホニウム塩。

【0236】 【化105】

140

50

【0237】ここで式Ar¹、Ar²は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。

【0238】Z-は、対アニオンを示し、例えばB F4-、AsF6-、PF6-、SbF6-、SiF6²-、Cl O4-、CF3SO3-等のパーフルオロアルカンスルホン 酸アニオン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核 芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸*10

* アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0239】また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの2つ及 VAr^1 、 Ar^2 はそれぞれの単結合又は置換基を介して 結合してもよい。

【0240】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0241]

【化106】

$$C_{12}H_{23} \qquad (PAG3-1) \qquad C_4H_6 \qquad (PAG3-2)$$

$$C_{12}H_{23} \qquad (PAG3-2) \qquad SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-2)$$

$$SbF_8 \qquad (PAG3-3) \qquad C_4H_6 \qquad (PAG3-4)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-4)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-4)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-6)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-8)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-8)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-10)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-10)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-10)$$

$$CF_3SO_3^{\Theta} \qquad (PAG3-11)$$

[0242]

【化107】

[0243] [化108]

特開2002-341539 154

[0245]

【化110】

[0246]

【化111】

-81-

[0247]

【化112】 PAG4-37

$$- \stackrel{\oplus}{\nabla} - \operatorname{Ph}_{2} \qquad {}^{\Theta}\operatorname{O}_{3}\operatorname{S} - \operatorname{C}_{4}\operatorname{F}_{9} \quad (PAG4-41)$$

[0249]

【0250】上記において、Phはフェニル基を表す。一般式 (PAG3)、 (PAG4)で示される上記オニウム塩は公知であり、例えば、米国特許第2,807,648 号及び同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方法により合成することができる。

Ar³—SO₂—SO₂—Ar⁴ (PAG5)

【0253】式中、Ar³、Ar⁴は、各々独立に、置換もしくは未置換のアリール基を示す。R²06は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。

*【0251】(3)下記一般式(PAG5)で表される ジスルホン誘導体又は一般式(PAG6)で表されるイ ミノスルホネート誘導体。

[0252]

【化115】

$$R^{206} - SO_2 - O - N$$
(PAG6)

【0254】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0255]

【化116】

[0256]

【化117】

[0257]

【化118】

【0258】 【化119】

10

30

40

$$\begin{array}{c|c}
O & O \\
N - O - S - CH_2 - CH_2
\end{array}$$
(PAG6-23)

$$\begin{array}{c|c}
O & O \\
N - O - S - C_4 F_9 & (PAG6-24) \\
O & O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & O \\
 & O \\$$

$$N-O-S-CF_3 \qquad (PAG6-26)$$

[0259] 【化120】

$$\begin{array}{c|c}
O & O \\
N - O - S - C_3H_7 & (PAG6-29)
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 & O & O \\
 & N - O - S \\
 & O \\$$

$$\begin{array}{c|c}
O & O \\
N - O - S - CH_2 - O \\
O & O
\end{array}$$
(PAG6-33)

$$\begin{array}{c|c}
O & O \\
N-O-S-C_4F_9 & (PAG6-34)
\end{array}$$

【0260】(4)下記一般式(PAG7)で表される ジアゾジスルホン誘導体。

[0261]

【化121】

【0262】ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル 基、あるいは置換していてもよいアリール基を表す。具 体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これら に限定されるものではない。

[0263]

【化122】 50

ができる。

【0265】〔3〕その他の添加剤

本発明のポジ型レジスト組成物には、必要に応じて更に 酸分解性溶解阻止化合物、染料、可塑剤、界面活性剤、 光増感剤、有機塩基性化合物、及び現像液に対する溶解 性を促進させる化合物等を含有させることができる。

【0266】本発明のポジ型レジスト組成物には、好ましくはフッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有する。本発明のポジ型レジスト組成物には、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれか、あるいは2種以上を含有することが好ましい。本発明のポジ型レジスト組成物が上記酸分解性樹脂と上記界面活性剤とを含有することにより、パターンの線幅が一層細い時に特に有効であり、現像欠陥が一層改良される。これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特

開昭63-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62834 号、特開平9-54432号、特開平9-5988号、米国特許54057 20号、同5360692号、同5529881号、同5296330号、同543 6098号、同5576143号、同5294511号、同5824451号記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。使用できる市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、(新秋田化成(株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ(株)製)、サーフロンS-382、SC10 1、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等フッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP-341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いること

174

【0267】界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準として、通常0.001重量%~2重量%、好ましくは0.01重量%~1重量%である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

【0268】上記の他に使用することのできる界面活性 剤としては、具体的には、ポリオキシエチレンラウリル エーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポ リオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレン オレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエー テル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテ ル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等の ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオ 30 キシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマ 一類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパル ミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモ ノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタン トリステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポ リオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキ シエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエ チレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレ ンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソル ピタントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビ タン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤等を挙 げることができる。これらの他の界面活性剤の配合量 は、本発明の組成物中の固形分100重量部当たり、通 常、2重量部以下、好ましくは1重量部以下である。

【0269】本発明で用いることのできる好ましい有機 塩基性化合物は、フェノールよりも塩基性の強い化合物 である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。

[0270] [化124]

50

【0271】ここで、R²⁵⁰、R²⁵¹及びR²⁵²は、各々 独立に、水素原子、炭素数1~6のアルキル基、炭素数 1~6のアミノアルキル基、炭素数1~6のヒドロキシ アルキル基又は炭素数6~20の置換もしくは非置換の アリール基であり、ここでR251とR252は互いに結合し て環を形成してもよい。

【0273】 (式中、R²⁵³、R²⁵⁴、R²⁵⁵及びR 256は、各々独立に、炭素数1~6のアルキル基を示 す) 更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環 境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であ り、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と 窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアル キルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例と しては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしく 30 ザビシクロ〔2.2.2〕オクタン、4ージメチルアミノ は未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミ ノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロ リジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もし くは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジ ン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未 置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置 換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換の ピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリ ン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン 等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノ アルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、ア リールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル 基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニ トロ基、水酸基、シアノ基である。

【0274】含窒素塩基性化合物の好ましい具体例とし て、グアニジン、1、1-ジメチルグアニジン、1、 1, 3, 3, -テトラメチルグアニジン、2-アミノピ リジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2 ージメチルアミノピリジン、4ージメチルアミノピリジ ン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチ

ル) ピリジン、2ーアミノー3ーメチルピリジン、2ー アミノー4ーメチルピリジン、2ーアミノー5ーメチル ピリジン、2-アミノー6-メチルピリジン、3-アミ ノエチルピリジン、4ーアミノエチルピリジン、3ーア ミノピロリジン、ピペラジン、N- (2-アミノエチ ル) ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペリジ ン、4-アミノー2,2,6,6-テトラメチルピペリ ジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジ ン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾー 10 ル、3-アミノー5-メチルピラゾール、5-アミノー 3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2 - (アミノメチル) - 5 - メチルピラジン、ピリミジ ン、2, 4-ジアミノピリミジン、4, 6-ジヒドロキ シピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N- (2-アミノエチル) モルフ オリン、1,5ージアザビシクロ〔4.3.0〕ノナー 5-エン、1,8-ジアザビシクロ〔5.4.0〕ウン デカー7ーエン、1,4ージアザビシクロ〔2.2.2〕 オクタン、2, 4, 5-トリフェニルイミダゾール、N 20 -メチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N-ヒド ロキシエチルモルホリン、N-ベンジルモルホリン、シ クロヘキシルモルホリノエチルチオウレア(CHMET U) 等の3級モルホリン誘導体、特開平11-5257 5号公報に記載のヒンダードアミン類 (例えば該公報

【0275】特に好ましい具体例は、1,5-ジアザビ シクロ [4.3.0] ノナー5ーエン、1,8ージアザビ シクロ [5.4.0] ウンデカー 7 ーエン、1,4ージア ピリジン、ヘキサメチレンテトラミン、4,4ージメチ ルイミダソリン、ピロール類、ピラゾール類、イミダゾ ール類、ピリダジン類、ピリミジン類、CHMETU等 の3級モルホリン類、ビス (1, 2, 2, 6, 6ーペン タメチルー4-ピペリジル) セバゲート等のヒンダード アミン類等を挙げることができる。中でも、1,5-ジ アザビシクロ〔4.3.0〕ノナー5ーエン、1,8-ジアザビシクロ〔5.4.0〕ウンデカー7ーエン、 1、4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン、4-40 ジメチルアミノピリジン、ヘキサメチレンテトラミン、 CHMETU、ビス (1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチ ルー4-ピペリジル) セバゲートが好ましい。

[0005] に記載のもの) 等が挙げられるがこれに限

定されるものではない。

【0276】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であ るいは2種以上組み合わせて用いられる。含窒素塩基性 化合物の使用量は、感光性樹脂組成物の全組成物の固形 分に対し、通常、0.001~10重量%、好ましくは 0.01~5重量%である。0.001重量%未満では 上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一 方、10重量%を超えると感度の低下や非認光部の現像 50 性が悪化する傾向がある。

177

【0277】本発明のポジ型レジスト組成物は、上記各 成分を溶解する溶剤に溶かして支持体上に塗布する。こ こで使用する溶剤としては、エチレンジクロライド、シ クロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、 y - プチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレング リコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノ エチルエーテル、2-メトキシエチルアセテート、エチ レングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピ レングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコ ールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エ 10 チル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸 メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチ ル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メ チルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、こ れらの溶剤を単独あるいは混合して使用する。

【0278】上記の中でも、好ましい溶剤としてはプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、2ーヘプタノン、γーブチロラクトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエ 20ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフランを挙げることができる。

【0279】本発明のこのようなポジ型レジスト組成物は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜の膜厚は0.2~1.2μmが好ましい。本発明において使用することができる無機基板とは、通常のBareSi基板、S0 30 G基板、あるいは次に記載の無機の反射防止膜を有する基板等を挙げることができる。また、本発明においては、必要により、市販の無機あるいは有機反射防止膜を使用することができる。

【0280】反射防止膜としては、チタン、二酸化チタ ン、窒化チタン、酸化クロム、カーボン、αーシリコン 等の無機膜型と、吸光剤とポリマー材料からなる有機膜 型が用いることができる。前者は膜形成に真空蒸着装 置、CVD装置、スパッタリング装置等の設備を必要と する。有機反射防止膜としては、例えば特公平7-69 611号記載のジフェニルアミン誘導体とホルムアルデ ヒド変性メラミン樹脂との縮合体、アルカリ可溶性樹 脂、吸光剤からなるものや、米国特許5294680号 記載の無水マレイン酸共重合体とジアミン型吸光剤の反 応物、特開平6-118631号記載の樹脂パインダー とメチロールメラミン系熱架橋剤を含有するもの、特開 平6-118656号記載のカルボン酸基とエポキシ基 と吸光基を同一分子内に有するアクリル樹脂型反射防止 膜、特開平8-87115号記載のメチロールメラミン とベンソフェノン系吸光剤からなるもの、特開平8-1 50 178

79509号記載のポリビニルアルコール樹脂に低分子 吸光剤を添加したもの等が挙げられる。また、有機反射 防止膜として、ブリューワーサイエンス社製のDUV3 0シリーズや、DUV-40シリーズ、ARC25、シ プレー社製のAC-2、AC-3、AR19、AR20 等を使用することもできる。

【0281】上記レジスト液を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上に(必要により上記反射防止膜を設けられた基板上に)、スピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは150 nm~250 nmの波長の光である。具体的には、KrFエキシマレーザー(248 nm)、ArFエキシマレーザー(193 nm)、F2エキシマレーザー(157 nm)、X線、電子ビーム等が挙げられる。

【0282】現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、nープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーnーブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

[0283]

【実施例】以下、本発明を実施例によって更に具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。

【0284】合成例(1) 樹脂(1)の合成
ノルボルネン、無水マレイン酸、tプチルアクリレート、2ーメチルシクロヘキシルー2ープロピルアクリレートをモル比で35/35/20/10で反応容器に仕込み、テトラヒドロフランに溶解し、固形分60%の溶液を調製した。これを窒素気流下65℃で加熱した。反応温度が安定したところで和光純薬社製ラジカル開始剤V-601を1mo1%加え反応を開始させた。8時間加熱した後、反応混合物をテトラヒドロフランで2倍に稀釈した後、反応混合物をテトラヒドロフランで2倍に稀釈した後、反応混合液の5倍容量のヘキサンに投入し白色粉体を析出させた。析出した粉体を濾過取り出しし、これをメチルエチルケトンに溶解し、5倍容量のヘキサン/tープチルメチルエーテル=1/1混合溶媒に再沈し、析出した白色粉体を適取、乾燥、目的物である樹脂(1)を得た。得られた樹脂(1)のGPCによる

179

00 (重<u></u> 里中均) であった。また、NMRスペクトルよ り樹脂 (1) の組成は本発明のノルボルネン/無水マレ イン酸/tプチルアクリレート/2-メチルシクロヘキ シルー2-プロピルアクリレートをモル比で32/39 /19/10であった。

*【0285】合成例(1)と同様の方法で以下、樹脂 (2)~(14)を合成した。以下に上記樹脂(2)~ (14) の組成比、分子量を示す。 [0286]

【表1】

樹脂	一般式(J) のモノマー	一般式(II) のモノマー	一般式(III) のモノマー	Mw
2	20/15	40	15/10	11900
3	32	37	20/8/3	10500
4	16	21	38/27	13900
5	15	22	34/29	12300
6	17	20	33/30	12400
7	18	24	32/26	13000
8	15	19	36/30	12700
9	15	20	29/10/26	13100
10	17	21	31/31	12800
11	18	17/3	30/32	13300
12	16	19	31/12/11/11	12600
13	20	22	58	14700
14	23	28	35/14	13300

【0287】また、以下に上記樹脂(1)~(14)の 構造を示す。

[0288]

【化126】

特開2002-341539

[0289]

【化127】

特開2002-341539

184

[0290]

【化128】

$$\begin{array}{c|c}
-CH-CH- -CH_2-CH- * CH_3 \\
\hline
0 & C-0 \\
\hline
0 & C \\
0 & C \\
\hline
0 & C \\
0 & C \\
\hline
0 & C \\
0 &$$

[0291]

【化129】

$$\begin{array}{c|c}
-CH-CH- & -CH_2-CH- \\
\hline
O & C=O \\
\hline
O & O
\end{array}$$
(13)

$$\begin{array}{c|c}
-CH-CH- & -CH_2-CH- * \\
\hline
C=0 \\
\hline
OH
\end{array}$$
(14)

【0292】合成例(2) 樹脂(15)の合成
ノルボルネンカルボン酸 t ブチルエステル、無水マレイン酸、2ーメチルー2ーアダマンチルアクリレート、ノルボルネンラクトンアクリレートをモル比で20/20/35/25で反応容器に仕込み、メチルエチルケトン/テトラヒドロフラン=1/1溶媒に溶解し、固形分60%の溶液を調製した。これを窒素気流下65℃で加熱した。反応温度が安定したところで和光純薬社製ラジカル開始剤V-601を3mo1%加え反応を開始させた。12時間加熱した後、反応混合物を5倍量のヘキサンに投入し白色粉体を析出させた。析出した粉体を再度メチルエチルケトン/テトラヒドロフラン=1/1溶媒に溶解させ5倍量のヘキサン/メチルtBuエーテルに投入し白色粉体を析出させ、濾過取り出した。この作業

を再度繰り返し、乾燥、目的物である樹脂 (15)を得30 た。得られた樹脂 (15)のGPCによる分子量分析 (RI分析)を試みたところ、ポリスチレン換算で11600(重量平均)、残留モノマーの量は0.4%であった。また、NMRスペクトルより樹脂 (15)の組成は本発明のノルボルネン/無水マレイン酸/2ーメチルー2ーアダマンチルアクリレート/ノルボルネンラクトンアクリレートをモル比で18/23/34/25であった。

【0293】合成例(2)と同様の方法で以下、樹脂(16)~(39)を合成した。以下に上記樹脂(1406)~(39)の組成比、分子量を示す。

[0294]

【表2】

190

189 **表2**

樹脂	一般式(1)	一般式(II)	一般式(III)	Mw
	のモノマー	のモノマー	のモノマー	<u> </u>
16	24	29	31/16	12300
17	21	28	32/29	11100
18	22	27	28/23	11300
19	27	31	24/18	10700
20	32	38	20/10	9700
21	31	35	21/13	9200
22	29	35	20/16	8900
23	35	39	23/3	8700
24	28	36	22/14	10600
25	28/8	44	20	9100
26	30/6	42	22	7700
27	46	47/3	4	6300
28	37/6	48	9	6800
29	34/10	51	5	7400
30	41	43	10/6	6700
31	39	42	11/8	B800
32	36	42	10/12	9300
33	39	43	14/4	9800
34	38	42	15/5	9300
35	24	27	25/24	12600
36	19	24	40/17	9600
37	29	32	34/5	10400
38	20	25	26/5/24	13400
39	16	24	32/24/4	12700

【0295】また、以下に上記樹脂 (15) ~ (39) の構造を示す。

[0296]

【化130】

[0297]

【化131】

[0298]

【化132】

特開2002-341539

[0299]

【化133】

特開2002-341539

197

$$\begin{array}{c|c}
 & -CH_2-CH - & -CH_2-C - \\
 & COO & CO$$

[0300]

【化134】

【0301】合成例(3) 酸発生剤 [Ia-1]の合 成

ジフェニルスルフォキシド50gをベンゼン800mL に溶解させ、ここに塩化アルミ200gを添加し、これ を24時間80℃で攪拌した。反応終了後、反応液を氷 2 Lにゆっくりとそそぎ込んだ。ここに濃塩酸400m Lを加え70℃で10分加熱した。反応液を室温まで冷 却後、酢酸エチルで洗浄し、濾過した。濾液に、ヨウ化 40 し、ジ (t-アミルフェニル) ヨードニウム硫酸塩を 4 アンモニウム200gを蒸留水400mLに溶かしたも のを加えた。析出した粉体を濾取、水洗、酢酸エチルで 洗浄、乾燥し、スルフォニウムヨージド62gを得た。 得られたスルフォニルヨージド48gをメタノール30 0mLに溶解し、これに酸化銀32gを加えて、4時間 攪拌した。反応液をフィルター濾過した後、ピス(トリ フルオロメチルスルフォニル) イミドと反応し、目的物 である [Ia-1] 32gを回収した。

【0302】合成例(4) 光酸発生剤[IIb-1]の 合成

t-アミルベンゼン60g、ヨウ素酸カリウム40g、 無水酢酸81g、ジクロロメタン170mLを混合し、 氷浴にて冷却しながら濃硫酸66.8gを2時間かけて 滴下した。反応液をそのまま2時間攪拌した後、室温で 1 晩攪拌、反応を完結させた。反応終了後、氷浴にて冷 却しながら反応液に蒸留水50mLを滴下し、抽出、有 機層を水、重曹水、水で洗浄、得られた有機層を濃縮 Og得た。得られた硫酸塩とビス(トリフルオロメチル スルフォニル) イミドカリウム塩を塩交換反応すること により、目的物である [IIb-1] を得た。

【0303】実施例1~39及び比較例1及び2

(ポジ型レジスト組成物組成物の調製と評価) 上記合成 例で合成した表3及び4に示す各成分を配合し、それぞ れ固形分14重量%の割合でプロピレングリコールモノ メチルエーテルアセテートに溶解した後、0. 1 μ mの ミクロフィルターで濾過し、実施例1~39と比較例

1、2のポジ型レジスト組成物を調製した。

202

201

[0304]

【表 3】

_				
	樹脂	光酸発生剤	塩基性	界面
	(1, 5g)		化合物	活性剂
			(5mg)	(5mg)
実施例1	(1)	la-1=40mg	1	W1
2	(2)	la-2=42mg	2	W1
3	(3)	Ia-3=45mg	3	W5
4	(4)	[a-4=43mg	4	W5
5	(5)	la-5=40mg	5	w3
6	(6)	La-1/PAG4-6	6	W5
		=30/15mg		
7	(7)	la-6=45mg	6	W4
8	(8)	la-7=50mg	6	W5
9	(9)	Ia-8=46mg	5	WЗ
10	(10)	la-9=50mg	1	W2
11	(11)	Is-10=46mg	2	なし
12	(12)	Ia-11=43mg	3	W1
13	(13)	Ia-12=43mg	2	W2
14	(14)	Ia-13/PAG 4-52	1	W3
		=30/10mg		
15	(15)	la-15=45mg	5	W2
16	(16)	la-17=60mg	5	W1
17	(17)	[a-22/PAG 4-39	4	W2
		=30/30mg		
18	(18)	llb-2=40mg	4	W5
19	(19)	∭b−7=40mg	4/5=1/1	W5
20	(20)	IIb−6/la−2=10/30mg	4	W5

[0305]

【表4】

203 38.4

樹脂	光酸発生剤	塩基性	界面
(1.5g)			活性剤
•		(5mg)	(5mg)
(21)	Ia-3/PAG4-50=30/10mg	5	W5
(22)	Ia-4/PAG 6-27=30/10mg	4	W5
(23)	La-5/PAG 7-5=40/10mg	5	W5_
(24)	Ia-6=45mg	4	wз
(25)	[a-10/PAG 4-35=20/20mg	5	w3
(26)	La-17/PAG 4-17=45/30mg	5	W1
(27)	Ia-23/PAG 4-52	3	W1
	=45/29mg		
(28)	la-21/PAG 4-50	2	W1
	=60/32mg		
(29)	Ia-17/PAG 4-48	1	W2
	=50/40mg		
(30)	Ia-22/PAG 4-52	2	W2
	=20/30mg		
(31)	la-19=50mg	なし	W5
(32)	la-4/PAG 4-6/PAG 4-5	5	W5
	=30/10/10mg		
(33)	[a-3=46mg	4	W5
(34)	Ia-2=44mg	4	- W5
(35)	La-1=42mg	3	W5
(36)	Ia-10-45mg	2	W5
(37)	Ia−14=46mg	1	W3
(38)	[a−11=50mg	3	W1
(39)	[a−2=43mg	5	W5
(2)	PAG 4-5=40mg	1	W1
(3)	PAG 3-5=40mg	1	W1
	(1.5g) . (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (2)	(1.5g) (21) Ia-3/PAG4-50=30/10mg (22) Ia-4/PAG 6-27=30/10mg (23) Ia-5/PAG 7-5=40/10mg (24) Ia-6=45mg (25) Ia-10/PAG 4-35=20/20mg (26) Ia-17/PAG 4-17=45/30mg (27) Ia-23/PAG 4-52 =45/29mg (28) Ia-21/PAG 4-50 =60/32mg (29) Ia-17/PAG 4-48 =50/40mg (30) Ia-22/PAG 4-52 =20/30mg (31) Ia-19=50mg (32) Ia-4/PAG 4-6/PAG 4-5 =30/10/10mg (33) Ia-3=46mg (34) Ia-2=44mg (35) Ia-1=42mg (36) Ia-10=45mg (37) Ia-14=46mg (38) Ia-1=50mg (39) Ia-2-43mg (39) Ia-2-43mg (20) PAG 4-5-40mg	(1.5g)

【0306】界面活性剤としては、

W1:メガファックF176 (大日本インキ (株) 製) (フッ素系)

W2:メガファックR08 (大日本インキ (株) 製) (フッ素及びシリコーン系)

W3:ポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化学工業(株)製)

W4:ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

W5:トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)

製)を表す。

【0307】アミンとしては、

1は、1,5-ジアザビシクロ〔4.3.0〕-5-ノ 40 ネン(DBN)を表し、

2は、ビス (1, 2, 2, 6, 6ーペンタメチルー4ー ピペリジル) セバゲート

3は、トリnープチルアミン

4は、トリフェニルイミダゾール

5は、アンチピリン

6は、2,6-ジイソプロピルアニリン

を表す。

【0308】 (評価試験) 初めにBrewer Sci ence社製ARC-25をスピンコーターを利用して 50

シリコンウエハー上に78nm塗布、乾燥した後、その30 上に得られたポジ型フォトレジスト組成物溶液をスピンコータを利用して塗布し、150℃で90秒間乾燥、約0.4μmのポジ型フォトレジスト膜を作成し、それにマスクを通してArFエキシマレーザーステッパー(ISI社製 NA=0.6)で露光した。露光後の加熱処理を130℃で90秒間行い、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で現像、蒸留水でリンスし、レジストパターンプロファイルを得た。これらについて、以下のように解像力、露光マージンを評価した。これらの評価結果を表5及び6に示す。

【0309】解像力: 0.14μ mのマスクパターンを再現する露光量に於ける限界解像力を示す。

図光マージン: 0.14μ mのラインアンドスペース (1/1)のマスクパターンを再現する図光量を最適図光量とし、 0.14μ m ± 10 %の線幅を再現する図光量幅を最適図光量で割った値を ± 100 分率(%)で表した。数字が大きいほど図光量変化に対して線幅変化が少ない。

[0310]

【表5】

表5

205

[0311]

· 【表 6 】

	解像力	離光マージン
	(<i>µ</i> m)	(%)
実施例21	0, 125	11
22	0. 125	10
23	0. 125	10
24	0. 125	10
25	0, 125	11
26	0. 125	11
27	0. 125	10
28	0. 125	11
29	0. 125	10
30	0. 125	11
31	0. 1325	8
32	0. 125	13
33	0. 125	10
34	0. 125	9
35	0. 125	11
36	0. 125	11
37	0. 125	14
38	0. 125	14
39	0. 125	10
比較例1	0. 14	2
2	解像せず	0

【0312】表5及び6の結果から明らかなように、本 発明のポジ型レジスト組成物は、解像力、露光マージン が優れていることが判る。

[0313]

【発明の効果】本発明は、解像力、露光マージンの優れ たポジ型レジスト組成物を提供することができる。従っ て、本発明のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、特に ArFエキシマレーザー光を使用するミクロファブリケ ーションに好適に使用することができる。

10

20

30

40

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷		職別記号	F I		デーマコート・(参え	季)
C08K	5/34		C 0 8 K	5/34		
	5/36			5/36		
C 0 8 L	33/04		C 0 8 L	33/04		
	45/00			45/00		
G 0 3 F	7/004	501	G03F	7/004	5 0 1	
		504			5 0 4	
H01L	21/027		H01L	21/30	5 0 2 R	

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA02 AB16 AC04 AC08 ADO3 BEO0 BG00 CC04 CC20 FA03 FA12 FA17 4J002 BG041 BG051 BG071 BG131 BH021 BK001 ER027 EU027 EU047 EU077 EU097 EU127 EU137 EU147 EU186 EU207 EU216 EU237 EV216 EV236 EV266 EV296 EV306 FD206 FD207 GP03 4J100 AJ02T AK32Q AL04R AL08R ALO8S ALO8T AM47Q AM47T ARO9P AR11P BAO2P BAO2R BAO2T BAO3P BAO3Q BAO3S BA04P BA05P BA06P BA11P BA11Q BA11S BA11T BA15P BA15S BA15T BA16P BA32T BA34P BA40P BA40T BA55Q BA55T BA58P BA58T BB07Q

> BC04P BC07P BC07Q BC07T BC08T BC09P BC09S BC12P BC23T BC53P BC53S CA03

CAO6 JA38

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成18年1月19日(2006.1.19)

【公開番号】特開2002-341539(P2002-341539A) 【公開日】平成14年11月27日(2002.11.27) 【出願番号】特願2001-149620(P2001-149620) 【国際特許分類】

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月29日(2005.11.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

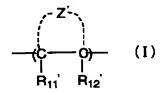
【請求項1】 (A) 脂肪族環状炭化水素基を有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解速度が増加する樹脂、及び

(B) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物

を含有するポジ型レジスト組成物において、

(A) の樹脂が、下記一般式(I)で表される繰返し構造単位、一般式(II)で表される繰返し構造単位、及び一般式(III)で表される繰返し構造単位を有する樹脂であり、(B) の化合物が、下記一般式(Ia)又は一般式(IIb)で表される化合物であることを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【化1】



式(I)中:

 R_{11} ', R_{12} 'は、各々独立に、水素原子、シアノ基、ハロゲン原子、又はアルキル基を表す。

Z'は、結合した2つの炭素原子(C-C)を含み、置換基を有していてもよい脂環式構造を形成するための原子団を表す。

【化2】

$$CH-CH CII)$$

一般式(II)中:

 Z_2 は、-O-又は-N(R_{41}) -を表す。ここで R_{41} は、水素原子、水酸基、アルキル基、ハロアルキル基、又は $-OSO_2-R_{42}$ を表す。 R_{42} は、アルキル基、ハロアルキル基、ソロアルキル基又は樟脳残基を表す。

【化3】

一般式(III)中:

Raiは、水素原子、低級アルキル基、ハロゲン原子又は一CNを表す。

 X_5 は、-O-、-S-、 $-NR_{93}-$ 、又は $-NR_{93}SO_2-$ を表す。 R_{93} は、水素原子、鎖状又は環状アルキル基を表す。

Bは、単結合または連結基を表す。

R₉₂は、水素原子、鎖状又は環状アルキル基、アルコキシ基、水酸基、カルボキシ基、シアノ基、-COOR₉₄、又は下記一般式(IV)~(X)のいずれかで表される基を表す。R₉₄は、水素原子、または鎖状又は環状アルキル基を表す。

【化4】

$$\begin{array}{c|c}
Rb_1 & Ra_1 \\
Rc_1 & Rd_1 \\
Re_1 & Re_1
\end{array}$$
(IV)

$$R_{1b}$$
 R_{4b}
 R_{2b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{2b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{3b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{4b}
 R_{5b}
 R_{4b}
 R_{4b}

$$-N^{+}(R_{95})(R_{96})(R_{97}) \cdot X^{-} (VIII)$$

 $-R_{98}-A_{50}-R_{99} (IX)$
 $-SO_{3}R_{100} (X)$

式 (IV) において、R a $_1$ 、R b $_1$ 、R c $_1$ 、R d $_1$ 、及びR e $_1$ は、各々独立に、水素原子又は炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表す。 m、nは各々独立に $0\sim 3$ の整数を表し、m+nは、2以上6以下である。

式 $(V-1) \sim (V-4)$ において、 $R_{1b} \sim R_{5b}$ は、各々独立に、水素原子、アルキル

基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。R_{1b}~R_{5b}の内の2つは、結合して環を 形成してもよい。

式(VII)において、 $R_{1d} \sim R_{8d}$ は、各々独立に、水素原子又はアルキル基を表す。 R_{d0} は、水素原子、鎖状または環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。mは、 $1\sim10$ の整数を表す。

式(VIII)中、R $_9$,~R $_9$,は、各々独立に、水素原子、鎖状または環状アルキル基、アルケニル基、アリール基、又はアラルキル基を表す。但し、R $_9$,~R $_9$,は互いに結合して非芳香環、芳香環を形成しても良い。 X^- は、R-SO $_3^-$ を表す。Rは脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基を表す。

式 (IX) 中、 $R_{,8}$ は、単結合、アルキレン基、アリーレン基、又はこれらを組み合わせた 2 価の基を表す。

Asoは、下記に示す官能基のいずれかを表す。

【化5】

R,,は、水素原子またはアルキル基を表す。

式 (X) 中、 R_{100} は、鎖状又は環状アルキル基、アリール基又はアラルキル基を表す。

【化6】

$$R_{2}^{-}$$
 S^{+} X^{-} (Ia)
 R_{3}^{-} R_{4}^{-} I^{+} R_{5}^{-} X^{-} (IIb)

(上記式中、 $R_1 \sim R_3$ は、各々独立に、置換基を有していてもよい脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基を表す。但し、 $R_1 \sim R_3$ の内の2個は、互いに結合して環を形成してもよく、また、 R_4 と R_5 とは、互いに結合して環を形成してもよい。 X^- は、下記のアニオンのいずれかを表す。)

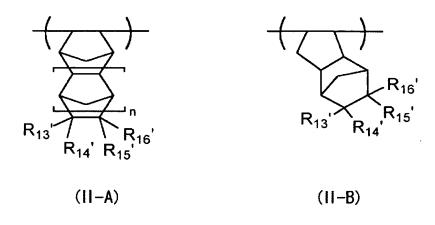
【化7】

X:

(上記式中、 $R_6 \sim R_{10}$ は、各々独立に、置換基を有していてもよい脂肪族炭化水素基を表す。但し、 $R_6 \geq R_7 \geq 2$ は、互いに結合して環を形成してもよく、また、 $R_8 \sim R_{10}$ の内の 2 個は、互いに結合して環を形成してもよい。)

【請求項2】 前記一般式(I)におけるZ'が、結合した2つの炭素原子(C-C)を含み、置換基を有していてもよい有橋式脂環式構造を形成するための原子団を表すことを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項3】前記一般式(I)が、下記一般式(II-A)又は一般式(II-B)であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。 【化8】



式 (II-A) 、 (II-B) 中:

 R_{13} '~ R_{16} 'は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、-COOH、- $COOR_{5}$ 、酸の作用により分解する基、-C(=O)-X-A '~ R_{17} '、又は置換基を有していてもよいアルキル基あるいは環状炭化水素基を表す。

ここで、R,は、置換基を有していてもよい、アルキル基、環状炭化水素基又は下記の-Y基を表す。

Xは、酸素原子、硫黄原子、-NH-、-NHSO2-又は-NHSO2NH-を表す。 A'は単結合又は 2 価の連結基を表す。

また、R₁₃'~ R₁₆'のうち少なくとも2つが結合して環を形成してもよい。nは0又は1を表す。

 R_{17} 'は、-COOH、-COOR,、-CN、水酸基、置換基を有していてもよいアルコキシ基、 $-CO-NH-R_6$ 、 $-CO-NH-SO_2-R_6$ 又は下記の-Y基を表す。

R₆は、置換基を有していてもよい、アルキル基又は環状炭化水素基を表す。

- Y基;

【化9】

(-Y基中、R₂1'~R₃0'は、各々独立に、水素原子又は置換基を有していてもよいアルキル基を表す。a, bは1又は2を表す。)

【請求項4】更に、フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項5】更に有機塩基性化合物を含有することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。